# การตรวจจับสัญญาณดิสชาร์จบางส่วนในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ด้วยการแปลงเวฟเล็ต

DETECTION OF PARTIAL DISCHARGE SIGNAL IN GENERATORS USING WAVELET TRANSFORMS

เริงฤทธิ์ กิจไพบูลทวี

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตร ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2563 ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

# การตรวจจับสัญญาณดิสชาร์จบางส่วนในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ด้วยการแปลงเวฟเล็ต



หัวข้อวิทยานิพนธ์	การตรวจจับสัญญาณดิสซาร์จบางส่วนในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยการแปลง เวฟเล็ต
	Detection of Partial Discharge Signal in Generators using Wavelet
ชื่อ - นามสกุล	Transforms นายเริงฤทธิ์ กิจไพบูลทวี
สาขาวิชา	วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุภพิทักษ์สกุล, Ph.D.
ปีการศึกษา	2563

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.....

ประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย์บุญยัง ปลั่งกลาง, Dr.-Ing.)

กรรมการ

กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ธนพงศ์ สุวรรณศรี, Dr.-Ing.)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐภัทร พันธ์คง, Ph.D.)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุภพิทักษ์สกุล, Ph.D.)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็น ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวกร อ่างทอง, Ph.D.) วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 หัวข้อวิทยานิพนธ์

การตรวจจับสัญญาณดิสซาร์จบางส่วนในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยการแปลง เวฟเล็ต นายเริงฤทธิ์ กิจไพบูลทวี วิศวกรรมไฟฟ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุภพิทักษ์สกุล, Ph.D. 2563

ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา



การเกิดดิสชาร์จบางส่วนในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มีสาเหตุมาจากความล้มเหลวของระบบฉนวน ในส่วนต่างๆของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หากไม่มีการซ่อมบำรุงจะทำให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงต่อเครื่อง กำเนิดไฟฟ้าในที่สุด ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องทำการตรวจวัดและวิเคราะห์การเกิดดิสชาร์จบางส่วน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับวางแผนบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพ

วิทยานิพนธ์นี้เสนออัลกอริทึมของการตรวจวัดและระบุตำแหน่งการเกิดดิสชาร์จบางส่วนใน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพิกัด 21kV ด้วยเทคนิคการแปลงเวฟเล็ต สัญญาณดิสชาร์จบางส่วนจะถูกนำมากรอง สัญญาณรบกวนออกด้วยเทคนิคการแปลงเวฟเล็ตแบบไม่ต่อเนื่อง จากนั้นจะส่งผ่านเข้าสู่กระบวนการ ระบุตำแหน่งด้วยเทคนิคการแปลงเวฟเล็ตแบบต่อเนื่องที่แสดงผลในโดเมนเวลา – ความถี่ โดยสัญญาณ ที่ตำแหน่งดังกล่าวจะถูกนำไปวิเคราะห์หาค่าความถี่ และเปรียบเทียบตามมาตรฐานคุณลักษณะสมบัติ การเกิดดิสชาร์จบางส่วนในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

จากผลการทดลองกับสัญญาณดิสซาร์จบางส่วนที่จำลองขึ้น พบว่าอัลกอริทึมที่นำเสนอ สามารถลดสัญญาณรบกวนจากสัญญาณต้นแบบที่สร้างขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถระบุ ตำแหน่งและให้ค่าความถี่ของสัญญาณดิสชาร์จบางส่วนได้อย่างถูกต้อง เมื่อนำไปทดลองใช้กับสัญญาณ ที่วัดจากโรงไฟฟ้าและทำการเปรียบเทียบกับผลที่ได้จากเครื่องมือวัดมาตรฐาน TGA-B พบว่าให้ผลไปใน ทิศทางเดียวกัน

คำสำคัญ : ดิสชาร์จบางส่วน การแปลงเวฟเล็ตแบบไม่ต่อเนื่อง การแปลงเวฟเล็ตแบบต่อเนื่อง

Thesis TitleDetection of Partial Discharge Signal in Generators Using<br/>Wavelet TransformsName- SurnameMr. Roengrit KitpaiboontaweeProgramElectrical EngineeringThesis AdvisorAssistant Professor Chatchai Suppitaksakul, Ph.D.Academic Year2020

### ABSTRACT

Partial discharge in the generator is caused by a failure of the insulation system in different parts of the generator. Without maintenance, it will eventually cause a severe damage to the generator. Therefore, it is necessary to perform partial discharge measurements and analyze in order to use as information in making a maintenance plan for the generator to work with stability.

This thesis proposes algorithms for measuring and locating Partial Discharge signals (PD) in a generator rated 21kV by wavelet transform techniques. The signal was filtered to decrease noise with Discrete Wavelet Transform (DWT). It is then located with Continuous Wavelet Transform (CWT) in the time-frequency domain. The obtained signal from CWT was analyzed for determining frequency in order to compare results according to the characteristics of partial discharges in generators.

The experiment results of the simulated signal indicated that the proposed algorithm could efficiently decrease noise and locate the signal. The PD frequency was also indicated correctly. After testing with the signal obtained from the power plant and comparing with the standard TGA-B instrument, the result was shown to be in the same direction.

Keywords: partial discharge signals, discrete wavelet transform, continuous wavelet transform

## กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี เพราะได้รับความอนุเคราะห์ ความช่วยเหลือจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย ศุภพิทักษ์สกุล ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไข ข้อบกพร่องต่างๆ กราบขอพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร. บุญยัง ปลั่งกลาง ประธานกรรมการสอบ วิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณฐภัทร พันธ์คง และรองศาสตราจารย์ ดร. ธนพงศ์ สุวรรณศรี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่กรุณาตรวจสอบ ชี้แนะแนวทางอันเป็นประโยชน์อย่างสูงในการจัดทำ วิทยานิพนธ์ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความ สมบูรณ์มากที่สุด ซึ่งผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณพ่อ แม่และครอบครัวของข้าพเจ้า ที่คอยให้การสนับสนุนทั้งเวลา กำลังใจ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านจากชั้นเริ่มต้นในการศึกษาถึงระดับปริญญาโท ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาจนผู้วิจัยสามารถนำเอาหลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ มาประยุกต์ใช้และ อ้างอิงในงานวิจัยครั้งนี้

คุณค่าอันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอมอบเพื่อบูชาพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ และ ผู้มีพระคุณทุกท่าน



เริงฤทธิ์ กิจไพบูลทวี

# สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	(3)
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	(4)
กิตติกรรมประกาศ	(5)
สารบัญ	(6)
สารบัญรูป	(9)
สารบัญตาราง (	(12)
บทที่ 1 บทนำ	13
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	13
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย	14
1.3 สมมุติฐานของงานวิจัย	14
1.4 ขอบเขตของการวิจัย	16
1.5 ขั้นตอนการวิจัย	16
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	16
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ	17
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	18
2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	18
2.2 ดิสชาร์จบางส่วน (Partial Discharge)	19
2.2.1 วงจรสมมูลการเกิดดิสชาร์จภายใน	20
2.3 การเกิดดิสชาร์จบางส่วนในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	21
2.4 คุณลักษณะของสัญญาณดิสชาร์จบางส่วน	22
2.5 ลักษณะเฉพาะของรูปแบบการเกิดดิสชาร์จบางส่วน	26
2.5.1 ปัญหาจากการขั้นตอนการผลิตที่ไม่เหมาะสม (Inadequate Bonding)	27
2.5.2 ปัญหาจากการเกิด Slot Discharge	28
2.5.3 ปัญหาจากความเครียดในสารเคลือบผิวต่าง ๆ	28
2.5.4 ปัญหาจากการคลายตัวของขดลวด (Loose Windings)	29
2.5.5 ปัญหาจากช่องว่างระหว่างเฟสที่ไม่เพียงพอ (Inadequate Spacing)	30
2.5.6 ปัญหาจากการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า (Electrical Connections)	30

# สารบัญ(ต่อ)

	หน้
2.5.7 ปัญหาจาก Surges	31
2.5.8 ปัญหาจากการเสื่อมสภาพด้วยความร้อน (Thermal Deterioration)	31
2.5.9 ปัญหาจากการปรับเปลี่ยนโหลด (Load Cycling)	32
2.5.10 ปัญหาจากความสกปรก (Contamination)	33
2.5.11 ปัญหาจากการสั่นสะเทือนบริเวณช่วงปลายของขดลวด	33
2.6 ฐานข้อมูลของผลการวัดสัญญาณดิสซาร์จบางส่วนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2015	34
2.7 การวิเคราะห์สัญญาณดิสชาร์จบางส่วน	35
2.7.1 ทฤษฎีพื้นฐานของการแปลงเวฟเล็ต	35
2.7.2 การแปลงเวฟเล็ต (Wavelet Transform: WT)	38
2.7.3 การแปลงเวฟเล็ตแบบต่อเนื่อง (Continuous Wavelet Transform )	40
2.7.4 การแปลงเวฟเล็ตแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Wavelet Transform)	42
2.7.5 เวฟเล็ตแม่ (Mother wavelet)	49
2.8 สรุปทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	54
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงานวิจัย	55
3.1 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย	55
3.2 การจำลองสัญญาณดิสชาร์จบางส่วน	56
3.3 การวิเคราะห์สัญญาณด้วยการแปลงเวฟเล็ต	60
3.4 ข้อมูลจริงที่ใช้ในการงานวิจัย	64
3.5 สรุปผลการดำเนินงานวิจัย	65
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์	66
4.1 ผลการวิเคราะห์ดิสชาร์จบางส่วนจากอัลกอลิทึมที่ออกแบบไว้บไว้	66
4.2 ผลการวิเคราะห์จากเครื่องมือวัดมาตรฐาน TGA-B	70
4.3 สรุปผลการวิเคราะห์	74
บทที่ 5 ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ	75
5.1 สรุปลการวิจัย	75
5.2 ข้อเสนอแนะ	75
5.3 งานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต	76

# สารบัญ(ต่อ)

รรณานุกรม าคผนวก		
ภาคผนวก ก	งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่	
ระวัติผู้เขียน		

# สารบัญรูป

## หน้า

รูปที่ 1.1	การแปลงเวฟเล็ต	15
รูปที่ 2.1	รูปแบบของดิสชาร์จบางส่วน (PD)	20
รูปที่ 2.2	วงจรสมมูลของวัสดุที่มีโพรงก๊าซและเกิดดิสชาร์จบางส่วนภายในขั้วบวก	20
รูปที่ 2.3	วงจรสมมูลเมื่อมีโพรงอากาศในเนื้อฉนวน	22
รูปที่ 2.4	Pulse Width และ Rise Time ของสัญญาณดิสชาร์จบางส่วน	22
รูปที่ 2.5	ย่านความถี่ที่ใช้ในการตรวจจับสัญญาณดิสชาร์จบางส่วน	22
รูปที่ 2.6	ตำแหน่งของสัญญาณดิสชาร์จบางส่วนที่เกิด และ ปริมาณ +PD และ –PD	23
รูปที่ 2.7	ตำแหน่งของ PD ว่าเกิดขึ้นที่บริเวณใด	23
รูปที่ 2.8	สัญญาณ -PD < +PD	23
รูปที่ 2.9	ตำแหน่งการเกิดสัญญาณ -PD < +PD	24
รูปที่ 2.10	สัญญาณ +PD ≈ -PD	24
รูปที่ 2.11	ตำแหน่งการเกิดสัญญาณ +PD ≈ –PD	24
รูปที่ 2.12	สัญญาณ -PD > +PD	25
รูปที่ 2.13	ตำแหน่งการเกิดสัญญาณ -PD > +PD	25
รูปที่ 2.14	แสดงการแปลงฟูเรียร์ (FFT	36
รูปที่ 2.15	แสดงการแปลงฟูเรียร์ช่วงเวลาสั้น (STFT)	38
รูปที่ 2.16	ลักษณะของเวฟเล็ตแม่ชนิด Daubechies20	39
รูปที่ 2.17	แสดงลักษณะของเวฟเล็ตแม่ที่ถูกสเกลและเลื่อนตำแหน่งไปที่ค่า a,b ต่าง ๆ กัน	39
รูปที่ 2.18	ลักษณะของการแตกกระจ่ายสัญญาณและการรวมกลับสัญญาณของเวฟเล็ต	40
รูปที่ 2.19	แสดงขั้นตอนที่ 1 และ 2 ของการแปลงเวฟเล็ต	41
รูปที่ 2.20	แสดงขั้นตอนที่ 3 ของการแปลงเวฟเล็ต	41
รูปที่ 2.21	แสดงขั้นตอนที่ 4 จนกระทั่งครบทุกสเกล	41
รูปที่ 2.22	การแสดงการแปลงเวฟเล็ตแบบต่อเนื่อง (CWT)	42
รูปที่ 2.23	ลักษณะการกระจาย (Decomposition) ของสเปซของเวกเตอร์	45
รูปที่ 2.24	ลักษณะการกระจาย (Decomposition) สัญญาณไปยังระดับความละเอียดต่าง ๆ	46
รูปที่ 2.25	แสดงการแปลงแยกสัญญาณด้วยฟิลเตอร์แบงค์แบบสองช่องสัญญาณ	47
รูปที่ 2.26	แสดงการแปลงกลับสัญญาณด้วยฟิลเตอร์แบงค์แบบสองช่องสัญญาณ	47

# สารบัญรูป(ต่อ)

		หน้า
รูปที่ 2.27	ลักษณะการแปลงเวฟเล็ตโดยใช้หลักการวิเคราะห์แบบออคเทฟฟิลเตอร์แบงค์	48
รูปที่ 2.28	แสดงการแปลงเวฟเล็ตแบบเต็มหน่วย (DWT) ในสเกลที่ 1-4	49
รูปที่ 2.29	แสดงลักษณะของ Haar Wavelet <u>ค</u>	50
รูปที่ 2.30	แสดงลักษณะของ Daubechies Wavelet	50
รูปที่ 2.31	แสดงลักษณะของ Biorthogonal Wavelet	51
รูปที่ 2.32	แสดงลักษณะของ Coiflets Wavelet	52
รูปที่ 2.33	แสดงลักษณะของ Symlets Wavelet	52
รูปที่ 2.34	แสดงลักษณะของ Morlet Wavelet	53
รูปที่ 2.35	แสดงลักษณะของ Mexican Hat Wavelet	53
รูปที่ 2.36	แสดงลักษณะของ Meyer Wavelet	53
รูปที่ 3.1	รูปแบบสัญญาณ Damped exponential pulse (DEP)	59
รูปที่ 3.2	รูปแบบสัญญาณ Damped oscillatory pulse (DOP)	59
รูปที่ 3.3	สัญญาณ DEP ร่วมกับ white Gaussian noise (WGN) at SNR -5 dB	59
รูปที่ 3.4	สัญญาณ DOP ร่วมกับ white Gaussian noise (WGN) at SNR -5 dB	60
รูปที่ 3.5	DWT coefficients (d1-d12, a12) of DEP type signal decomposed up to	
	level 12 using db4 mother wavelet	61
รูปที่ 3.6	De-noised DEP type signal ระดับ 12	61
รูปที่ 3.7	DWT coefficients (d1-d12, a12) of DOP type signal decomposed up to	
	level 12 using db4 mother wavelet	62
รูปที่ 3.8	De-noised DOP type signal ระดับ 12	63
รูปที่ 3.9	หาค่า Time Frequency Domain (DEP) ด้วยเวฟเล็ตแบบต่อเนื่อง CWT	63
รูปที่ 3.10	หาค่า Time Frequency Domain (DOP) ด้วยเวฟเล็ตแบบต่อเนื่อง CWT	64
รูปที่ 3.11	ทดสอบด้วยค่า Sample rate ที่ 100MS/s ,Sample to read ที่ 5M ที่เฟส A	64
รูปที่ 4.1	สัญญาณผิดปกติเกิดขึ้นที่มุม0°ค่าSample rate 100 M/s ,Sample to read 5M	66
รูปที่ 4.2	decomposed up to level 6 using db4 mother wavelet	67
รูปที่ 4.3	ผลของการลดสัญญาณด้วยเวฟเล็ตแบบไม่ต่อเนื่องระดับ 6	68
รูปที่ 4.4	Time - Frequency Domain signal	68

# สารบัญรูป(ต่อ)

รูปที่ 4.5	รูปร่างของสัญญาณสัญญาณที่เฟส A Sample rate 100 MS/s		
	และ Sample to read 5M   ในช่วงเวลา x = 6.22x10 <sup>4</sup>	69	
รูปที่ 4.6	ความถี่จากการแปลงเวฟเล็ตแบบต่อเนื่อง CWT	69	
รูปที่ 4.7	จุดที่ทำการตรวจสอบหาสาเหตุของสัญญาณดิสชาร์จบางส่วน	70	
รูปที่ 4.8	สัญญาณดีสชาร์จบางส่วนที่สตรีมเทอร์ใบน์ 10 เฟส A มุม 90° และ 270°	71	
รูปที่ 4.9	จุดที่ทำการตรวจสอบหาสาเหตุที่สตรีมเทอร์ไบน์ 10 เฟส A	71	
รูปที่ 4.10	จุดที่พบสาเหตุของการเกิดสัญญาณผิดปกติที่สตรีมเทอร์ไบน์ 10 เฟส A	72	
รูปที่ 4.11	จุดที่เกิดความเสียหายของรู Isolated Phase Bus ที่ทำการการต้าปเกลียวไม่ดี	72	
รูปที่ 4.12	Data Report STG 10 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2017	73	



## สารบัญตาราง

ตารางที่ 2.1	ลักษณะเฉพาะรูปแบบของการเกิดสัญญาณดิสชาร์จบางส่วนในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	26
ตารางที่ 2.2	ปัญหาจากการขั้นตอนการผลิตที่ไม่เหมาะสม (Inadequate Bonding)	27
ตารางที่ 2.3	ปัญหาจากการเกิด Slot Discharge	28
ตารางที่ 2.4	ปัญหาจากความเครียดในสารเคลือบผิวต่าง ๆ (Stress Coating Interface)	29
ตารางที่ 2.5	ปัญหาจากการคลายตัวของขดลวด (Loose Windings)	29
ตารางที่ 2.6	ปัญหาจากช่องว่างระหว่างเฟสที่ไม่เพียงพอ (Inadequate Spacing)	30
ตารางที่ 2.7	ปัญหาจากการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า (Electrical Connections)	31
ตารางที่ 2.8	ปัญหาจาก Surges	31
ตารางที่ 2.9	ปัญหาจากการเสื่อมสภาพด้วยความร้อน (Thermal Deterioration)	32
ตารางที่ 2.10	ปัญหาจากการปรับเปลี่ยนโหลด (Load Cycling)	32
ตารางที่ 2.11	ปัญหาจากความสกปรก (Contamination)	33
ตารางที่ 2.12	ฐานข้อมูลความรุนแรงของการเกิด PD พิกัด 21 kV	34
ตารางที่ 3.1	พารามิเตอร์ที่ใช้การจำลองสัญญาณดิสชาร์จบางส่วน	58
ตารางที่ 3.2	คุณลักษณะสมบัติของ DSI ที่ใช้ในการจำลองสัญญาณ	58



บทที่ 1 บทนำ

### 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ฉนวนในระบบไฟฟ้าเป็นส่วนหลักของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ถึงแม้จะมีความเจริญก้าวหน้าทาง เทคโนโลยีการผลิตฉนวนที่สมบูรณ์แบบ แต่ในความเป็นจริงแล้วฉนวนนั้นยังคงมีความผิดพร่อง และ ปนเปื้อนไปกับ สิ่งสกปรกชนิดต่าง ๆ และนั่นเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของ ความล้มเหลวในระบบฉนวน ของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ดังนั้นจำเป็นต้องมีการตรวจสอบการเสื่อมสภาพของฉนวนไฟฟ้า เพื่อใช้เป็น ข้อมูลในการประเมิน ที่อาจเกิดขึ้นในอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและอาจนำไปสู่ความเสียหายในระบบต่อไป ในระบบการฉนวนไฟฟ้าแรงสูง ถ้าหากความเครียดสนาม ไฟฟ้าที่จุดใด เกิดมีค่าสูงกว่าค่า ความเครียด สนามไฟฟ้าวิกฤติ หรือค่าความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้า (Dielectric strength) ของฉนวนจะทำให้เกิด เบรกดาวน์โดยสมบูรณ์ หรือเบรกดาวน์เป็นเพียงบางส่วน หรือที่เรียกว่า "ดิสชาร์จบางส่วน" [1] พัลส์ ดิสชาร์จบางส่วนแต่ละครั้งจะมีพลังงานถ่ายเทให้กับพื้นผิวฉนวน ในลักษณะชนกระแทกเป็นเหตุให้เกิด ความร้อนเพิ่มขึ้นเฉพาะจุด เป็นผลให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี ทำให้ฉนวนเสียเป็นจุดๆ และเกิดผิดพร่อง ขยายตัวมากขึ้น และอาจนำไปสู่การเกิดเบรกดาวน์อย่างสมบูรณ์ได้ ดิสชาร์จบางส่วนแบ่งออกเป็น 3 แบบคือ โคโรนาดิสซาร์จ ดิสซาร์จตามผิวและดิสซาร์จบางส่วนแบบภายในรอยต่อ การเกิดดิสซาร์จ บางส่วนที่ฉนวนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จากข้อมูลที่มีการเก็บรวมรวมบันทึกไว้ทางสถิติ [2] พบว่า รูปแบบการเกิดดิสชาร์จบางส่วนนั้น จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งของข้อบกพร่อง ในขดลวด สเตเตอร์และเทคนิคการตรวจวัด ดังนั้นการวิเคราะห์รูปแบบการเกิดสัญญาณดิสชาร์จบางส่วนของ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะเป็นประโยชน์อย่างมากในตรวจจับและการบำรุงรักษาตามประเภทของ ข้อบกพร่องในเครื่องกำเนิด

การวิเคราะห์สัญญาณดิสซาร์จบางส่วนในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ด้วยการประมวลผลการกระจาย ข้อมูลดิสซาร์จบางส่วนด้วยขนาดของพัลส์ และเฟสที่เกิดขึ้นโดยอ้างอิงกับฐานเวลารูปคลื่นไซน์ 50 Hz จากคุณสมบัติของดิสซาร์จบางส่วนกล่าวคือ เป็นสัญญาณที่ไม่แน่นอน ไม่เป็นรายคาบ เกิดขึ้นใน ระยะเวลาอันสั้นและมีความถี่สูง ประมาณ 50 – 250 MHz [3] ดังนั้นวิธีการวิเคราะห์ดิสซาร์จบางส่วน ดังกล่าว จึงไม่สามารถประมวลผลข้อมูลภาคสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในโดเมนเวลาหรือโดเมน ความถี่ เนื่องจากสัญญาณรบกวนสูง การวิเคราะห์ด้วย FFT นั้นดีสำหรับรูปคลื่นที่เป็นรายคาบ มีเวลา การเกิดที่แน่นอน ดังนั้นที่เวลาใดๆ ถ้าทราบความถี่ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นจะทำให้เข้าใจถึงการ เปลี่ยนแปลงความถี่ของสัญญาณที่เวลาต่างๆ ดียิ่งขึ้นมีผลทำให้การวิเคราะห์สัญญาณดิสซาร์จบางส่วน มีความถูกต้องเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นต้องแสดงสัญญาณในโดเมนเวลาและ ความถี่ (time-frequency domain) พร้อมกัน ซึ่งเป็นการแสดงกราฟความถี่บนแกน x , เวลาบน แกน y และแอมพลิจูดบนแกน z นั่นคือ ทำให้ทราบที่เวลาใดๆ มีความถี่อะไรเกิดขึ้นและความถี่นั้นๆ มีมากน้อยเพียงใด การแปลงเวฟเล็ต [4] จึงเป็นเครื่องมือที่ดีในการวิเคราะห์สัญญาณที่ไม่เป็นรายคาบ เนื่องจากมันสามารถแยกสัญญาณรบกวนออกจากสัญญาณต้นแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและแสดงค่า ทั้งในโดเมนเวลาและความถี่ได้ ทำให้ผลการวิเคราะห์รูปแบบการเกิดดิสชาร์จบางส่วนเป็นไปอย่างมี ประสิทธิผล

ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยสนใจที่จะสร้างอัลกอริทึม เพื่อประเมินสภาพฉนวนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ ตรวจวัดได้จากโรงไฟฟ้าบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด มาวิเคราะห์สัญญาณดิสชาร์จบางส่วนด้วยการแปลง เวฟเล็ต โดยการจำลองสัญญาณดิสชาร์จบางส่วน ด้วยฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์ร่วมกับสัญญาณรบกวน และแยกสัญญาณรบกวนด้วย การแปลงเวฟเล็ตแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Wavelet Transform : DWT) แสดงส่วนประกอบความถี่ของสัญญาณที่ต้องสงสัย และระบุตำแหน่งที่เกิดด้วยเวฟเล็ต แบบต่อเนื่อง (Continuous Wavelet Transform: CWT) นำผลการทดลอง ไปใช้กับสัญญาณดิสชาร์จ บางส่วนที่วัดได้จริง เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าระบบเชิงป้องกัน ต่อไป

## 1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย

1.2.1 เพื่อศึกษาการเกิดดิสชาร์จบางส่วนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพิกัด ไม่เกิน21 kV

1.2.2 เพื่อศึกษาเทคนิคและการวิเคราะห์ดิสชาร์จบางส่วน ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยการ แปลงเวฟเล็ต

1.2.3 เพื่อสร้างอัลกอริทึมจำลองสัญญาณดิสชาร์จบางส่วนที่เกิดขึ้น ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
1.2.4 เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

### 1.3 สมมุติฐานของงานวิจัย

ดิสชาร์จบางส่วนที่เกิดขึ้นในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นปรากฏการณ์ที่ฉนวนของขดลวดบาง ส่วน มีสภาพนำไฟฟ้า แต่ฉนวนโดยรวมยังสามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติ แต่จะทำให้ฉนวนเกิดการเสื่อมสภาพ เร็วกว่าที่ควร ดิสชาร์จบางส่วนที่เกิดขึ้นในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่จะก่อให้เกิดอันตราย อย่างเฉียบพลัน แต่เมื่อเกิดดิสชาร์จบางส่วนขึ้นแล้วจะเร่งให้ฉนวนเสื่อมสภาพเร็วขึ้น และ จะมีผลให้ เกิดดิสชาร์จบางส่วนมากขึ้นเช่นกัน ถ้าไม่ได้รับการตรวจสอบหาดิสชาร์จบางส่วน ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และ แก้ไขในช่วงเวลาที่เหมาะสม ดิสชาร์จบางส่วนอาจกลายเป็นสาเหตุโดยตรงของการล้มเหลว (Breakdown) ของฉนวนอย่างถาวร ทั้งนี้การตรวจพบการเกิดดิสชาร์จบางส่วน ทำให้ทราบถึงปัญหา เพื่อนำมากำหนดแนวทางแก้ไขให้ถูกต้อง จะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

การวิเคราะห์สัญญาณด้วยการแปลงเวฟเล็ต (Wavelet Transform) เป็นวิธีการวิเคราะห์ สัญญาณที่ได้รับการพัฒนามาจากการแปลงฟูริเยร์และการแปลงฟูริเยร์ในช่วงเวลาอันสั้น โดยมีการปรับ ช่วงเวลาและความถี่ให้เหมาะสมตามความต้องการผ่านกระบวนการแปลงเวฟเล็ต การวิเคราะห์ สัญญาณด้วยวิธีการแปลงเวฟเล็ตจะสามารถขยายช่วงเวลาในส่วนของวินโดว์ให้ยาวขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูล ช่วงความถี่ต่ำ ที่เที่ยงตรงขึ้นและยอมให้ลดช่วงเวลาในส่วนของวินโดว์ลงเพื่อให้ ได้ข้อมูลช่วงความถี่สูงที่ เที่ยงตรงขึ้นเช่นกัน ดังรูปที่ 1.1 แสดงให้เห็นการแปลงเวฟเล็ต



รูปที่ 1.1 การแปลงเวฟเล็ต [4]

การวิเคราะห์สัญญาณด้วยการแปลงเวฟเล็ตจะไม่แสดงข้อมูลเชิงเวลากับความถี่แต่จะแสดง ข้อมูลเชิงเวลากับสเกล (scale) แทน ข้อดีของการใช้การแปลงเวฟเล็ต คือ ความสามารถในการ วิเคราะห์สัญญาณเฉพาะที่ นอกจากนี้การวิเคราะห์สัญญาณด้วยวิธีเวฟเล็ตจะแสดงให้เห็นข้อมูลที่ไม่ ปรากฏในการวิเคราะห์สัญญาณแบบอื่นๆ เช่นข้อมูล ของสัญญาณจุดแตกหัก (Breakdown) จุดแตกหัก ในอนุพันธ์ลำดับที่สูงขึ้นไปของสัญญาณ (Breakdown at Higher Derivatives) และ Self-Similarity นอกจากนี้การวิเคราะห์เวฟเล็ต ยังสามารถบีบอัดสัญญาณ และ สามารถกำจัดสัญญาณรบกวนได้โดย ลดทอนคุณภาพของสัญญาณลงไปจากเดิมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ฟังก์ชั่นเวฟเล็ตมีลักษณะพิเศษที่สำคัญ คือสมาชิกของฟังก์ชั่นเวฟเล็ตจะเป็นสัญญาณที่เกิด จากต้นแบบอันเดียวกัน โดยที่ต้นแบบของสัญญาณ เวฟเล็ตดังกล่าวจะเรียกว่า "เวฟเล็ตแม่" (Mother Wavelet) ฟังก์ชั่นเวฟเล็ตจะมีการสั่นตามแนวแกน นอนซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงระยะเวลาอันสั้น ก่อนจะเข้าสู่ศูนย์ทั้งด้านบวกและด้านลบซึ่งต่าง จากฟังก์ชั่นไซน์ที่แผ่ไปตามแนวแกนนอน โดยที่ขนาดสัญญาณไม่มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงทำให้สามารถ นำฟังก์ชั่นเวฟเล็ตไปใช้ในการ วิเคราะห์สัญญาณที่ไม่คงที่โดยเลือกช่วงเวลาและความถี่ที่ต้องการได้

#### 1.4 ขอบเขตของการวิจัย

1.4.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลการเกิดดิสชาร์จบางส่วน ที่เกิดขึ้นในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พิกัด21 kV

1.4.2 สร้างอัลกอริทึมที่ใช้ในการวิเคราะห์สัญญาณดิสชาร์จบางส่วน

1.4.3 วิเคราะห์แบบจำลองสัญญาณด้วยการแปลงเวฟเล็ต

1.4.4 นำอัลกอริทึมที่ได้ใช้วิเคราะห์สัญญาณที่วัดได้จริงจากโรงไฟฟ้าบริษัทราชบุรี เพาเวอร์ จำกัด

## 1.5 ขั้นตอนการวิจัย

1.5.1 ศึกษาทฤษฎีและหลักการเกิดดิสชาร์จบางส่วนในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

1.5.2 ศึกษาการวิเคราะห์สัญญาณดิสชาร์จบางส่วนที่เกิดขึ้นในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยการ แปลงเวฟเล็ต

1.5.3 สร้างแบบจำลองสัญญาณดิสซาร์จบางส่วนและสัญญาณรบกวน

1.5.4 วิเคราะห์ข้อมูลสัญญาณที่ได้จากแบบจำลองและข้อมูลจริงจากการตรวจจับดิสชาร์จ บางส่วนในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

### 1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.6.1 ใช้เป็นต้นแบบ ในการตรวจวัดหาดิสชาร์จบางส่วนในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

1.6.2 ใช้เป็นข้อมูลการประกอบการตัดสินใจในการวางแผนบำรุงรักษาในระบบ ConditionBase Maintenance (CBM) เพื่อลดระยะเวลาในการบำรุงรักษา

1.6.3 ลดต้นทุนในการซื้อเครื่องมือวัดดิสชาร์จบางส่วนแบบมาตรฐาน Turbine Generator Analyzer (TGA-B)

1.6.4 ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้เชี่ยวชาญมาดำเนินการตรวจสอบดิสชาร์จบางส่วน

### 1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ

- 1.7.1 Partial Discharge ดิสชาร์จบางส่วน
- 1.7.2 Steam Turbine Generator เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันไอน้ำ
- 1.7.3 Signal processing การประมวลผลสัญญาณ
- 1.7.4 Wavelet Transform การแปลงเวฟเล็ต
- 1.7.5 Fourier Transform ฟูเรียร์ทรานฟอร์ม
- 1.7.6 Mother Wavelet เวฟเล็ตแม่
- 1.7.7 Electrical Test การทดสอบทางไฟฟ้า
- 1.7.8 Condition Base Maintenance การบำรุงรักษาตามสภาพ
- 1.7.9 Wavelet Reconstruction การรวมกลับเวฟเล็ต
- 1.7.10 Inverse Wavelet Transform การแปลงกลับเวฟเล็ต
- 1.7.11 Continuous Wavelet Transform: CWT การแปลงเวฟเล็ตแบบต่อเนื่อง
- 1.7.12 Discrete Wavelet Transform : DWT การแปลงเวฟเล็ตแบบไม่ต่อเนื่อง



# บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การเกิดดิสชาร์จบางส่วนในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีสาเหตุมาจากความไม่สมบูรณ์ของฉนวน สามารถเกิดได้ระหว่างผิวฉนวนของขดลวดแบบ Stator Core ระหว่างฉนวนกับตัวนำ ภายในเนื้อฉนวน บริเวณรอยต่อระหว่างส่วนที่มีศักย์สูงกับส่วนที่ Ground บริเวณ Jumper และ Coil End พลังงานของ ดิสชาร์จบางส่วนนั้นจะแปรผันตรงกับค่า Capacitance ของโพรงอากาศ ในขณะที่อากาศเกิดการแตก ตัว จะแปรผันเป็นกำลังสองกับขนาดแรงดันระหว่างโพรงอากาศนั้น ดังนั้นโพรงอากาศที่มีลักษณะกว้าง และยาวจะทำให้เกิดดิสซาร์จบางส่วนที่มีพลังงานสูง และในสภาวะปกติขณะเดินเครื่องฉนวนต้องรับทั้ง ความเครียดทางไฟฟ้า ความเครียดเชิงกล และ ความเครียดทางความร้อน ทำให้ฉนวนเกิดการ เสื่อมสภาพตามเวลาการใช้งาน แต่เมื่อเกิดดิสซาร์จบางส่วนขึ้นก็จะยิ่งเร่งให้ฉนวนเสื่อมสภาพมากขึ้น เมื่อฉนวนเสื่อมสภาพก็จะเกิดดิสชาร์จบางส่วนมากขึ้น ฉนวนจะยิ่งเสื่อมสภาพเร็วขึ้นไปอีก ดิสชาร์จ บางส่วนจะเป็นสาเหตุหลักโดยตรงของการล้มเหลวของฉนวน ดังนั้นสิ่งสำคัญในการแก้ไข การ ตรวจสอบให้พบแต่เนิ่นๆ และทำการแก้ไข การตรวจสอบสามารถตรวจสอบโดยวิธีวิเคราะห์สัญญาณ ดิสชาร์จบางส่วนจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผ่าน Coupling ซึ่งเป็นคาปาซิเตอร์และนับอัตราการเกิด สัญญาณพัลส์ของดิสชาร์จบางส่วนจากการวิเคราะห์สัญญาณในช่วงเวลาอันสั้น โดยมีการปรับช่วงเวลา และความถี่ให้เหมาะสม ตามความต้องการผ่านกระบวนการแปลงเวพเล็ต

การวิเคราะห์สัญญาณด้วยวิธีการแปลงเวฟเล็ตจะสามารถขยายช่วงเวลาในส่วนของวินโดว์ให้ ยาวขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลช่วงความถี่ต่ำ ที่เที่ยงตรงขึ้นและยอมให้ลดช่วงเวลาในส่วนของวินโดว์ลงเพื่อให้ ได้ข้อมูลช่วงความถี่สูงที่เที่ยงตรงขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้การวิเคราะห์เวฟเล็ตยังสามารถบีบอัดสัญญาณ และ สามารถกำจัดสัญญาณรบกวนได้ โดยลดทอนคุณภาพของสัญญาณลงไปจากเดิมเพียงเล็กน้อย เท่านั้น และนำผลการวิเคราะห์การเกิดดิสชาร์จบางส่วนมาระบุตำแหน่งที่เกิดดีสชาร์จบางส่วน เพื่อ กำหนดแนวทางการแก้ไข และในอนาคตจะมีการติดตั้งอย่างแพร่หลายเพื่อใช้ในระบบ Condition Base Maintenance (CBM) เพื่อลดระยะเวลาในการบำรุงรักษา และช่วยประเมินอายุการทำงานของ เครื่องกำเนิดด้วย

## 2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การเกิดดิสชาร์จบางส่วนที่ฉนวนของขดลวดสเตเตอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แสดงบนฐาน รูปคลื่นไซน์ และนำไปสู่การวิเคราะห์หาสาเหตุ ซึ่งพบว่ารูปแบบการเกิดดิสชาร์จบางส่วนนั้นแตกต่างกัน ไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งของข้อบกพร่องในขดลวดสเตเตอร์ และเทคนิคการตรวจวัด ดังนั้นการวิเคราะห์

รูปแบบ PD ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะเป็นประโยชน์ในการควบคุมและบำรุงรักษาตามประเภทของ [5] และการวิเคราะห์ยังสามารถแบ่งออกเป็นหลากหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น การ ข้อบกพร่อง วิเคราะห์รูปแบบ Phase Resolved Partial Discharge Pattern (PRPDP) ในรูปแบบสองมิติ และสาม มิติ แต่ต้องแปลความหมายโดยผู้มีประสบการณ์ [6,7] เทคนิคตรวจวัดดิสชาร์จบางส่วนในโดเมนเวลา ้บนพื้นฐาน pulse-by-pulse และแยกสัญญานการรบกวนโดยการประมวลผลสัญญาณและการใช้ เทคนิคตัวกรองแบนด์วิดท์แคบแบบปรับได้ narrow-bandwidth filter ถูกนำมาใช้ในการวิเคาระห์ [8] การแยกสัญญาณดิสชาร์จบางส่วนที่เกิดขึ้นมีการประ เมินวิธี denoising หลายวิธี โดยใช้ข้อมูลดิสชาร์จ บางส่วนที่จำลอ และข้อมูลจริงพบว่าการ denoising แบบเวฟเล็ตทำได้ดีทั้งข้อมูลจำลองและข้อมูลจริง ของสัญญาณ [9,10] การแยกสัญญาณดิสชาร์จบางส่วนออกจากสัญญาณรบกวนอื่น ๆ ที่ มีอยู่ในเครื่อง กำเนิดไฟฟ้าแรงสูงด้วยการแปลงเวฟเล็ตแบบไม่ต่อเนื่อง เพื่อลดสัญญาณรบกวน และใช้เทคนิคTime-Of-Arrival ใช้เพื่อระบุว่าเป็นสัญญาณดิสชาร์จแบบภายใน หรือภายนอก [11] นอกจากนี้การวิเคราะห์ โดเมนความถี่-เวลาของสัญญาณดิสชาร์จบางส่วน สามารถทำได้โดยใช้ S-transform แปลงเป็น เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวิเคราะห์นี้ [12] มีการนำเสนอแนวทางใหม่ในการกำหนดค่าเวฟ เล็ตสำหรับการลดสัญญาณดิสชาร์จบางส่วน แบบออนไลน์และผลการจำลองแสดงให้เห็นว่าฟังก์ชั่น threshold ใหม่ให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นโดยใช้เวลาในการประมวลผลน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเทคนิคอื่น ๆ ที่มีอยู่ใน ลดสัญญาณรบกวน [13] การแปลงเวฟเล็ต ได้รับการสรุปในงานวิจัยที่ได้ศึกษาว่ามีข้อดี เมื่อ เทียบกับวิธีก่อนหน้านี้เช่น FT และ STFT และสรุปว่าเหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์สัญญาณดิสชาร์จ บางส่วน [14,15]

### 2.2 ดิสชาร์จบางส่วน (Partial Discharge) [1]

ในระบบการฉนวนไฟฟ้าแรงสูง ไม่ว่าจะเป็นสายส่งจ่ายหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงก็ตาม ถ้า หากความเครียดสนามไฟฟ้าที่จุดใดเกิดมีค่าสูงกว่าค่าความเครียดสนามไฟฟ้าวิกฤติ หรือค่าความคงทน ต่อแรงดันไฟฟ้า (Dielectric strength) ของฉนวนจะทำให้เกิดเบรกดาวน์โดยสมบูรณ์ หรือเบรกดาวน์ เป็นเพียงบางส่วน หรือที่เรียกว่า "ดิสชาร์จบางส่วน"

ดีสชาร์จบางส่วนจะเกิดขึ้นในระบบฉนวนที่มีลักษณะสนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอสูงหรือฉนวน ที่ มีความไม่สม่ำเสมอหรือเป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งทำให้ความเครียดสนามไฟฟ้าบางจุด ในฉนวนมี ค่าสูงกว่า ค่าความเครียดสนามไฟฟ้าวิกฤติ แต่ไม่อาจทำให้เกิดเบรกดาวน์โดยสมบูรณ์ได้ หากแต่เกิด เพียงบางส่วนเท่านั้นพัลส์ดีสชาร์จบางส่วนแต่ละครั้งจะมีพลังงานถ่ายเทให้กับพื้นผิวฉนวน ในลักษณะชน กระแทกเป็นเหตุให้เกิดความร้อนเพิ่มขึ้นเฉพาะจุด เป็นผลให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี ทำให้ฉนวนเสียเป็นจุดๆ และเกิดผิดพร่องขยายตัวมากขึ้น และอาจนำไปสู่การเกิดเบรกดาวน์อย่างสมบูรณ์ ทำให้ฉนวนเสียหาย อายุการใช้งานของฉนวนจะสั้นลงดิสชาร์จบางส่วนแบ่งออกเป็น 3 แบบคือ โคโรนาดิสชาร์จ ดิสชาร์จ ตามผิวและ ดิสชาร์จบางส่วนแบบภายในรอยต่อ แสดงในรูปที่ 2.1



รูปที่ 2.2 วงจรสมมูลของวัสดุที่มีโพรงก๊าซและเกิดดิสซาร์จบางส่วนภายในขั้วบวก [1]

วัสดุฉนวนมีโพรงก๊าซภายในเนื้อฉนวนและฉนวนวางอยู่ระหว่างอิเล็กโทรด A-B แสดงในรูปที่ 2.2 โพรงก๊าซจะเขียนแทนด้วยความจุไฟฟ้า  $C_c$  ส่วนฉนวนที่ต่ออนุกรมกับโพรงก๊าซหรือ  $C_c$  เขียน แทนด้วยความจุไฟฟ้า  $C_b$  ส่วนที่ต่ออนุกรมกับ  $C_c$ นี้จะรวมกันได้เป็น  $C_b$  ส่วนฉนวนที่สมบูรณ์ดีอยู่ โดยรอบของ  $C_c$  จะให้ค่าเป็น  $C_a$  และรวมกันในส่วนนี้จะได้เป็น  $C_a$  ดังรูปที่ 2.2 ซึ่งค่าความจุ ไฟฟ้าของวัสดุทดสอบ C, จะมีค่าโดยประมาณเท่าๆ กับ C่ลซึ่งมีค่ามากกว่า C, มากๆ นั่นคือ ขั้วบวก

$$C_t \approx C_a \gg C_c \triangleright C_b \tag{2.1}$$

ถ้าแรงดันที่ป้อนทำให้แรงดันตกคร่อมโพรงก๊าซมีค่าสูงกว่าค่าแรงดันเบรกดาวน์ของโพรงก๊าซที่ แทนด้วย  $C_c$  จะเกิดเบรกดาวน์ในโพรงก๊าซ ซึ่งแทนด้วยช่องว่างอากาศ (g) โดยมีความต้านทาน  $R_c$  ต่อ อนุกรมอยู่เป็นตัวกำจัดกระแสดิสชาร์จ  $i_c(t)$  ซึ่งมีลักษณะเป็นพัลส์กว้างเป็นนาโนวินาที และทำให้เกิด แรงดันตก  $\delta U_c$  ที่โพรงก๊าซเกิดการปล่อยประจุดังสมการที่ 2.2

$$\Delta q_c = \delta U_c C_c \tag{2.2}$$

กระแส  $i_c(t)$  นี้ไหลอยู่ภายในซึ่งไม่สามารถวัดได้ แต่การดิสชาร์จของ  $C_c$  ทำให้เกิดการถ่ายเท ประจุของ  $C_b$  และ  $C_a$  ของวงจรสมมูล เป็นผลให้เกิดแรงดันตกที่ขั้ว A-B เท่ากับ  $\delta U_t$  ซึ่งหาได้จาก ประจุใน  $C_c$  ดังสมการที่ 2.3

$$\delta U_t = \frac{C_b \delta U_c}{C_b + C_a}$$
(2.3)

### 2.3 การเกิดดิสชาร์จบางส่วนในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า [1]

โดยปกติแล้วในฉนวนของขดลวดสเตเตอร์ จะมีโพรงของอากาศปะปนอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องใหม่ก็ตาม ถ้าโพรงอากาศนั้นมีขนาด 1 มิลลิเมตร แรงดันของเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าตกคร่อมโพรงอากาศมีค่าสูงกว่า 3 kV/mm (Vair/Dair) จะเกิดการเบรกดาวน์ขึ้นภายในโพรง อากาศ ดังรูปที่ 2.3 และในทุก 1 ไซเคิลจะเกิดการเบรกดาวน์ 2 ครั้ง เรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการเกิด สัญญาณดิสชาร์จบางส่วนคือการมีฉนวนบางส่วนเกิดสภาพการนำไฟฟ้าแต่ไม่ทำให้ฉนวนโดยรวม ล้มเหลวในการเป็นฉนวน โดยขณะที่มีแรงดันตกคร่อมโพรงอากาศเรียกว่า "ภาวะการชาร์จ" และ ขณะที่โพรงอากาศเกิดการเบรกดาวน์ เรียกว่า "ภาวะการดิสชาร์จ" ซึ่งจะเกิดทั้งลูกคลื่นบวก และ ลูกคลื่นลบ ของแรงดันรูปคลื่น Sine Wave และจะเป็นเช่นนี้ไปตลอดจนกว่าจะได้รับการแก้ไข หรือ จนกว่าฉนวนนั้นจะเกิดการล้มเหลว



รูปที่ 2.3 วงจรสมมูลเมื่อมีโพรงอากาศในเนื้อฉนวน [1]

### 2.4 คุณลักษณะของสัญญาณดิสชาร์จบางส่วน [3]

สัญญาณดิสชาร์จบางส่วนเป็นสัญญาณที่มี Pulse Width แคบ และมี Rise Time น้อย ประมาณ 1-5 nS ดังรูปที่ 2.4 และความถี่ของสัญญาณดิสชาร์จบางส่วนจะอยู่ในช่วง 1/(4xRise Time) ประมาณ 50 - 250 MHz ดังรูปที่ 2.5



รูปที่ 2.4 Pulse Width และ Rise Time ของสัญญาณดิสชาร์จบางส่วน



**รูปที่ 2.5** ย่านความถี่ที่ใช้ในการตรวจจับสัญญาณดิสชาร์จบางส่วน [3]

ดิสชาร์จบางส่วนนั้นเกิดขึ้นหลายจุดภายในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยเฉพาะภายใน Slot Portion นั้นจะเกิดได้ง่าย การแก้ไขทำได้ยาก ปัญหาการเกิด Breakdown ของฉนวนจะเกิดใน Slot Portion เป็นส่วนใหญ่ เราจึงให้ความสำคัญกับสัญญาณดิสชาร์จบางส่วนที่ตำแหน่งนี้มากที่สุด สัญญาณ ดิสชาร์จบางส่วนที่เกิดขึ้นมีทั้ง +PD และ –PD ปริมาณของสัญญาณดิสชาร์จบางส่วนใน Slot Portion สามารถจำแนกได้ 3 ตำแหน่งดังรูปที่ 2.6



ร**ูปที่ 2.6** ตำแหน่งของสัญญาณดิสชาร์จบางส่วนที่เกิด และ ปริมาณ +PD และ –PD [3]

เพื่อความเข้าใจในการอธิบายขั้วของสัญญาณดิสชาร์จบางส่วน ว่าสามารถบอกตำแหน่งว่า เกิดขึ้นที่ใด



**รูปที่ 2.8** สัญญาณ+PD > -PD [3]

ร**ูปที่ 2.9** ตำแหน่งการเกิดสัญญาณ +PD > -PD [3]

จากรูปที่ 2.8และ2.9 สัญญาณดิสชาร์จบางส่วนที่วัดได้พบว่า +PD เด่นชัดกว่าหรือมากกว่า – PD สัญญาณดิสชาร์จบางส่วนที่เกิดขึ้นอยู่ที่ตำแหน่งบนผิวของขดลวด สาเหตุเกิดจากการคลายตัวของ ขดลวด หรือ การเสื่อมของสารเคลือบผิว



**รูปที่ 2.11** ตำแหน่งการเกิดสัญญาณ +PD ≈ -PD [3]

จากรูปที่ 2.10 และ2.11 สัญญาณดิสชาร์จบางส่วนที่วัดได้พบว่า +PD มีปริมาณใกล้เคียงกับ -PD สัญญาณดิสชาร์จบางส่วนที่เกิดขึ้นอยู่ที่ตำแหน่ง ภายในเนื้อฉนวน เรียกว่า Internal Discharge สาเหตุเกิดจากการเสื่อมสภาพด้วยความร้อน หรือ การเคลือบฉนวนไม่ดี



2.4.3 สัญญาณ -PD > +PD

ร**ูปที่ 2.13** ตำแหน่งการเกิดสัญญาณ -PD > +PD [3]

จากรูปที่ 2.12 และ 2.13 สัญญาณดิสซาร์จบางส่วนที่วัดได้พบว่า –PD เด่นชัดกว่าหรือ มากกว่า +PD สัญญาณดิสซาร์จบางส่วนที่เกิดขึ้นอยู่ที่ตำแหน่งใกล้กับลวดทองแดงตัวนำ สาเหตุเกิด จากการปรับเปลี่ยนโหลด (Load Cycling) หรือ เกิดความร้อนสูงทำให้เกิดฟองอากาศใกล้ขด ลวดทองแดง

## 2.5 ลักษณะเฉพาะของรูปแบบการเกิดดิสชาร์จบางส่วน [3]

ปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายสาเหตุนั้นจะมีรูปแบบของดิสชาร์จบางส่วนที่เป็นลักษณะเฉพาะ ดังนั้นการตรวจสอบลักษณะของดิสชาร์จบางส่วนที่วัดได้ จะช่วยในการระบุสาเหตุของการเกิดปัญหาใน ระบบได้

สาเหตุ	Polarity	ผลจากโหลด	ผลจากอุณหภูมิ	มุมที่เกิด
การผลิตที่ไม่	ค่าด้านบวกจะใกล้	ไม่มี	แปรผกผัน	45° และ
เหมาะสม	เคียงกับค่าด้านลบ		กับอุณหภูมิ	225°
Slot Discharge	ค่าด้านบวกจะมาก กว่าค่าด้านลบ (≈1.5 เท่า)	ไม่มี	แปรผกผัน กับอุณหภูมิ	225°
สารเคลือบผิวต่างๆ	ค่าด้านบวกจะมาก กว่าค่าด้านลบ (≈1.5 เท่า)	ไม่มี	แปรผกผัน กับอุณหภูมิ	225°
การคลายตัวของ	ค่าด้านบวกจะมาก	สัญญาณด้าน	แปรผกผัน	225°
ขดลวด	กว่าค่าด้านลบ (≈1.5 เท่า)	บวกแปรผัน ตามโหลด	กับอุณหภูมิ	
ช่องว่างระหว่างเฟส ที่ไม่เพียงพอ	ค่าด้านบวกจะใกล้ เคียงกับค่าด้านลบ	ไม่มี	ไม่แน่นอน	45°,75°, 195° และ 225°
การเชื่อมต่อทาง ไฟฟ้า	ค่าด้านบวกจะใกล้ เคียงกับค่าด้านลบ	ไม่แน่นอน	ไม่แน่นอน	0° ແລະ 180°
Surge	ค่าด้านลบจะมาก กว่าค่าด้านบวก (≈1.5 เท่า)	ไม่แน่นอน	ไม่แน่นอน	0° ແລະ 180°

ตารางที่ 2.1 ลักษณะเฉพาะของรูปแบบการเกิดดิสชาร์จบางส่วนในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า [3]

สาเหตุ	Polarity	ผลจากโหลด	ผลจากอุณหภูมิ	มุมที่เกิด
การเสื่อมสภาพจาก ความร้อน	ค่าด้านบวกจะใกล้ เคียงกับค่าด้านลบ	ค่อนข้างน้อย	แปรผกผันกับ อุณหภูมิ	45° ແລະ 225°
การปรับเปลี่ยน โหลด	ค่าด้านลบจะมาก กว่าค่าด้านบวก (≈1.5 เท่า)	ค่อนข้างน้อย	แปรผกผันกับ อุณหภูมิ	45°
ความสกปรก	ค่าด้านบวกจะใกล้ เคียงกับค่าด้านลบ	ไม่มี	ไม่แน่นอน	15°,75°, 195° ແລະ 225°

ตารางที่ 2.1 ลักษณะเฉพาะของรูปแบบการเกิดดิสชาร์จบางส่วนในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ต่อ)

2.5.1 ปัญหาจากการขั้นตอนการผลิตที่ไม่เหมาะสม (Inadequate Bonding)

ในระหว่างกระบวนการผลิตขดลวดนั้น เมื่อมีการใช้ส่วนประกอบจำพวกเรซิ่น หรือเทปต่าง ๆ รวมถึงกระบวนการ VPI และปัจจัยอื่น อาจส่งผลให้เกิดโพรงของอากาศขึ้นภายในขดลวดได้ ตัวอย่างเช่น การเสื่อมของฉนวนอันเนื่องมาจากความร้อนนั้น จะทำให้เกิดโพรงของอากาศกระจายไป ทั่วฉนวน โดยไม่กระจุกตัวอยู่ทางด้านใดด้านหนึ่ง (ไม่ว่าจะเป็นด้านทองแดง หรือด้านของ Core) ทำให้ ไม่สามารถระบุขั้วของสัญญาณดิสชาร์จบางส่วนซึ่งจะเกิดขึ้นที่มุม 45° และมุม 225° ได้ นอกจากนี้ การ เสื่อมของฉนวนอันเนื่องมาจากความร้อนนี้ จะส่งผลให้สัญญาณดิสชาร์จบางส่วนที่เกิดขึ้น มีค่าลดลงเมื่อ อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น นั่นคือ จะแปรผกผันกับอุณหภูมิ อย่างไรก็ตาม สัญญาณดิสชาร์จบางส่วนที่เกิดขึ้นนี้ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโหลด

ตารางที่ 2.2 ปัญหาจากการขั้นตอนการผลิตที่ไม่เหมาะสม (Inadequate Bonding) [16]

สาเหตุ	Polarity	ผลจากโหลด	ผลจากอุณหภูมิ	มุมที่เกิด PD
การผลิตที่ไม่	ค่าทางด้านบวก	ไม่มี	แปรผกผัน	45° และ 225°
เหมาะสม	จะใกล้เคียงกับ		กับอุณหภูมิ	
	ค่าทางด้านลบ			

### 2.5.2 ปัญหาจากการเกิด Slot Discharge

Slot Discharge คือ ดิสชาร์จที่เกิดขึ้นระหว่างผิวของขดลวด กับแกนเหล็กสเตเตอร์ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่า สัญญาณดิสชาร์จบางส่วนที่เกิดจากการคลายตัวของขดลวด (Loose Windings) สามารถก่อให้เกิด Slot Discharge ได้ แต่การเกิด Slot Discharge ไม่จำเป็นต้องมีสาเหตุมาจากการ คลายตัวของขดลวดเท่านั้น บางครั้งยังอาจมีสาเหตุมาจากปัญหาอื่น เช่น สารเคลือบที่เป็นแบบกึ่งตัวนำ (Semi-Conductive Coating) เป็นต้น โดยรูปแบบของสัญญาณดิสชาร์จที่เกิดจาก Slot Discharge นี้ จะมีลักษณะใกล้เคียงกับสัญญาณดิสชาร์จบางส่วนที่เกิดจากการคลายตัวของขดลวด นั่นคือ จะเป็น สัญญาณดิสชาร์จบางส่วนทางด้านขั้วบวก เกิดขึ้นที่มุม 225° และแปรผกผันกับการเปลี่ยนแปลงของ อุณหภูมิ แต่เนื่องจาก Slot Discharge สามารถเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะเกิดการคลายตัวของขดลวด ดังนั้น มันจึงไม่มีผลกระทบใด ๆ จากการเปลี่ยนแปลงของโหลด อนึ่ง การเกิด Slot Discharge นี้ ยังเป็น สาเหตุให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงเพิ่มขึ้นได้เช่นกัน

ตารางที่ 2.3 ปัญหาจากการเกิด Slot Discharge [16]

Diminicommercy

สาเหตุ	Polarity	ผลจากโหลด	ผลจากอุณหภูมิ	มุมที่เกิด PD
Slot	ค่าด้านบวกจะ	ไม่มี	แปรผกผัน	225°
Discharge	มากกว่าค่าด้านลง	J	กับอุณหภูมิ	
	(≈1.5 เท่า)			

2.5.3 ปัญหาจากความเครียดในสารเคลือบผิวต่าง ๆ (Stress Coating Interface)

สัญญาณดิสชาร์จบางส่วนที่เกิดขึ้นบริเวณสารเคลือบผิวต่าง ๆ จะเป็นแบบ Surface-Type นั่นคือ จะขึ้นอยู่กับค่าแรงดัน Phase-to-Ground Voltage โดยจะเป็นสัญญาณดิสชาร์จบางส่วน ทางด้านขั้วบวก และเกิดขึ้นที่มุม 225° อย่างไรก็ตาม สัญญาณดิสชาร์จบางส่วนประเภทนี้จะแตกต่าง จากสัญญาณดิสชาร์จบางส่วนที่เกิดขึ้นจากการคลายตัวของขดลวด กล่าวคือ จะไม่มีผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงของโหลด และเนื่องจากวัสดุที่ใช้ในสารเคลือบผิวเหล่านี้ได้ถูกออกแบบมาให้มีลักษณะเป็น สื่อไฟฟ้า (ความนำไฟฟ้าจะแปรผันตามอุณหภูมิ) ดังนั้น เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น สัญญาณดิสชาร์จบางส่วน จะมีค่าเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน นั่นคือ อาจกล่าวได้ว่า ในกรณีที่รูปแบบของสัญญาณดิสชาร์จบางส่วนที่ พบนั้น อยู่ทางด้านขั้วบวก เกิดขึ้นที่มุม 225° และมีค่าแปรผันตามอุณหภูมิแล้ว จะมีความเป็นไปได้สูง มากที่จะเกิดจากความเสื่อมสภาพของสารเคลือบผิวต่าง ๆ และในกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง นั้น อาจเกิดพัลส์ขึ้นที่มุม 0° และมุม 180° ซึ่งเป็นค่าทั่วไปของการเกิดอาร์ค

สาเหตุ	Polarity	ผลจากโหลด	ผลจากอุณหภูมิ	มุมที่เกิด PD
สารเคลือบผิว ต่างๆ	ค่าด้านบวกจะ มากกว่าค่าด้าน	ไม่มี	แปรผกผันกับ อุณหภูมิ	225°
	ลบ (≈1.5 เท่า)			

ตารางที่ 2.4 ปัญหาจากความเครียดในสารเคลือบผิวต่าง ๆ (Stress Coating Interface) [16]

2.5.4 ปัญหาจากการคลายตัวของขดลวด (Loose Windings)

เมื่อเกิดการคลายตัวของขดลวดขึ้นใน Slot ปัญหาที่จะเกิดขึ้นทันที (ในกรณีที่ไม่ได้รับการ แก้ไข) ก็คือ การคลายตัวนี้จะทำให้ชั้นผิวของแกนสเตเตอร์ไปทำลายสารเคลือบผิวของขดลวด อย่าง รวดเร็ว และทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดแรงดันตกคร่อมบริเวณนี้ หรือระหว่างบริเวณ นี้กับแกนของสเตเตอร์โดยในกรณีที่แรงดันตกคร่อมนี้มีค่าสูงกว่าค่าแรงดัน Breakdown ของ Gas จะ ทำให้เกิดดิสชาร์จขึ้น นั่นคือ พัลส์ที่เกิดขึ้นจากการคลายตัวของขดลวด จะมีลักษณะเป็นแบบ Surface-Type ในบริเวณ Slot โดยจะเป็นสัญญาณทางด้านขั้วบวก และเกิดขึ้นที่มุม 225° ทั้งนี้ ข้อสังเกตที่ เด่นชัดสำหรับกรณีการคลายตัวของขดลวดนี้จะได้แก่การเพิ่มขึ้นของสัญญาณดิสชาร์จบางส่วนอย่าง รวดเร็ว (โดยเฉพาะสัญญาณทางด้านขั้วบวก) เมื่อโหลดมีการเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ คือ เมื่อ กระแสโหลด มีค่าเพิ่มขึ้น ขดลวดจะมีการสั่นสะเทือนเพิ่มมากขึ้น การสั่นสะเทือนนี้จะทำให้โพรงของ อากาศระหว่างบริเวณด้านข้างของขดลวดกับ Ground Core เพิ่มมากขึ้น และ โพรงของอากาศที่ เพิ่มขึ้นเหล่านี้จะส่งผลให้สัญญาณดิสชาร์จบางส่วนทางด้านขั้วบวกมีค่าเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน

ตารางที่ 2.5 ปัญหาจากการคลายตัวของขดลวด (Loose Windings) [16]

สาเหตุ	Polarity	ผลจากโหลด	ผลจากอุณหภูมิ	มุมที่เกิด PD
การคลายตัว	ค่าทางด้านบวกจะ	สัญญาณทางด้าน	แปรผกผันกับ	225°
ของขดลวด	มากกว่าค่าทางด้าน	บวกแปรผันตาม	อุณหภูมิ	
	ลบ (≈1.5 เท่า)	โหลด		

อย่างไรก็ตาม การที่กระแสโหลดมีค่าเพิ่มสูงขึ้นนี้ จะส่งผลให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน และจะส่งผลให้สัญญาณดิสซาร์จบางส่วน (ซึ่งแปรผกผันกับอุณหภูมิ) มีค่าลดลง ดังนั้น เมื่อต้องการ ตรวจสอบกรณี การคลายตัวของขดลวดนี้ ให้ทำการทดสอบด้วยการเดินเครื่องที่โหลดต่าง ๆ กัน แต่ ควบคุมให้ค่าแรงดันไฟฟ้า อุณหภูมิ และค่าความดันของไฮโดรเจนมีค่าใกล้เคียงกัน อนึ่ง สำหรับขดลวด ที่มีเฉพาะปัญหาจากการคลายตัวนั้น จะมีเฉพาะสัญญาณดิสชาร์จบางส่วนทางด้านขั้วบวกที่จะ เปลี่ยนแปลงตามโหลดในขณะที่สัญญาณดิสชาร์จบางส่วนทางด้านขั้วลบจะมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก สำหรับกรณีที่สัญญาณดิสชาร์จบางส่วนทางด้านขั้วลบมีการเปลี่ยนแปลงตาม โหลดนั้น อาจเป็นการ แสดงถึงการสั่นสะเทือนของตัวนำ เนื่องจากผลของโพรงของอากาศที่เกิดขึ้นในบริเวณใกล้ กับตัวนำ

2.5.5 ปัญหาจากช่องว่างระหว่างเฟสที่ไม่เพียงพอ (Inadequate Spacing)

สาเหตุของการเกิดสัญญาณดิสชาร์จบางส่วนประเภทนี้ (ซึ่งจะมีลักษณะใกล้เคียงกับกรณีการ เกิดสัญญาณดิสชาร์จบางส่วนจากความสกปรก) จะมีขึ้นอยู่กับค่าแรงดัน Phase-to-Phase Voltage นั่นคือ ค่าของมุมจะเปลี่ยนไป 30° จากสัญญาณปกติ และเนื่องจากการเกิดสัญญาณดิสชาร์จบางส่วน จากสาเหตุนี้มักจะแตกต่างจากกรณีอื่น รูปแบบของสัญญาณดิสชาร์จบางส่วนที่เกิดขึ้นในบางครั้ง จะ สามารถระบุเฟสที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งในกรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเฟสที่เกี่ยวข้องทั้งสองเฟสนั้น มีความสามารถ ในการตรวจสอบปัญหาจากช่วงปลายของขดลวด และลักษณะของการเกิด 30° Phase Shift นั้น จะ เป็นไปตามลักษณะของ Rotation ของเครื่องจักรนั้น ๆ นอกจากนี้ เนื่องจากสัญญาณดิสชาร์จบางส่วน ประเภทนี้ สามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างขดลวดบนสุด กับ ขดลวดล่างสุดใน Slot ดังนั้น การตรวจสอบด้วย สายตาอาจทำได้ค่อนข้างลำบาก

ตารางที่ 2.6 ปัญหาจากช่องว่างระหว่างเฟสที่ไม่เพียงพอ (Inadequate Spacing) [16]

สาเหตุ	Polarity	ผลจากโหลด	ผลจากอุณหภูมิ	มุมที่เกิด PD
ช่องว่างที่	ค่าทางด้านบวก	ไม่มี	ไม่แน่นอน	45°, 75°, 195°
ไม่เพียงพอ	จะไกล้เคียงกับค่า ทางด้านลบ	2001- 9/11/a 85%	52-5	และ 225°

2.5.6 ปัญหาจากการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า (Electrical Connections)

สัญญาณดิสชาร์จบางส่วนจากบริเวณจุดเชื่อมต่อต่าง ๆ จะปรากฏอยู่ในรูปของสัญญาณ ดิสชาร์จบางส่วนที่ขึ้นอยู่กับระบบทางกล โดยจะเกิดขึ้นที่มุม 0° และมุม 180° และเนื่องจากการ เชื่อมต่อที่ไม่ดีนี้อาจถูกผลกระทบได้จากทั้งการเปลี่ยนแปลงของโหลด และการเปลี่ยนแปลงของ อุณหภูมิ จึงไม่สามารถคาดคะเนแนวทางการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณดิสชาร์จบางส่วนได้

ตารางท์	2.7	ปัญหาจากก	ารเชื่อมต่อา	ทางไฟฟ้า	(Electrical	Connections)	[16]
---------	-----	-----------	--------------	----------	-------------	--------------	------

สาเหตุ	Polarity	ผลจากโหลด	ผลจากอุณหภูมิ	มุมที่เกิด PD
การเชื่อมต่อ ที่ไม่ดี	ค่าทางด้านบวก จะใกล้เคียงกับค่า	ไม่แน่นอน	ไม่แน่นอน	0° และ 180°
	ทางด้านลบ	$\triangle$		
		Ŧ		

2.5.7 ปัญหาจาก Surges

ความเครียดจาก Surge ที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ กันบนจุดเชื่อมต่อทางกลระหว่าง Groundwall กับ Strand หรือกับฉนวนของ Turn จะส่งผลให้จุดเชื่อมต่อนั้น เสื่อมสภาพลง และเสียหายได้ และจะ ก่อให้เกิดโพรงของอากาศขึ้นในฉนวนทางด้านของแกนทองแดง สัญญาณดิสชาร์จบางส่วนที่เกิดขึ้นจาก สาเหตุนี้ จะเกิดขึ้นทางด้านขั้วลบ เกิดขึ้นที่มุม 45° และมีลักษณะเช่นเดียวกับกรณีการเกิดโพรงของ อากาศขึ้นภายในฉนวนทั่วไป กล่าวคือ จะมีลักษณะของการแปรผกผันกับอุณหภูมิ ทั้งนี้ ในกรณีที่โพรง ของอากาศนั้นมีขนาดใหญ่มาก จะมีความเป็นไปได้ว่าสัญญาณดิสชาร์จบางส่วนทางด้านขั้วลบจะมีการ เพิ่มขึ้นตามโหลดเนื่องจากผลของการสั่นสะเทือนของตัวนำที่เพิ่มมากขึ้นตามแรงทางกลที่เพิ่มสูงขึ้น และในกรณีของเครื่องจักรแบบ Multi-Turn Coil เช่น มอเตอร์นั้น จะมีลักษณะใกล้เคียงกับการเกิด ปัญหาจาก Turn-to-Turn Fail

ตารางที่ 2.8 ปัญหาจาก Surges [16]

		G(3)		
สาเหตุ	Polarity	ผลจากโหลด	ผลจากอุณหภูมิ	มุมที่เกิด PD
Surge	ค่าทางด้านลบ	ค่อนข้างน้อย	แปรผกผันกับ	45°
	มากกว่าค่าด้าน		อุณหภูมิ	
	บวก (≈1.5 เท่า)	ทิดโนโลยีร	1.0.	

2.5.8 ปัญหาจากการเสื่อมสภาพด้วยความร้อน (Thermal Deterioration)

การเสื่อมสภาพด้วยความร้อนเป็นผลมาจากการเดินเครื่องที่ค่าสูงสุดติดต่อกันเป็นเวลานาน หรือจากการเดินเครื่องที่ค่าสูงกว่าค่าพิกัด (แม้จะเป็นเวลาสั้น ๆ ก็ตาม) ซึ่งจะให้ผลเช่นเดียวกับระบบ ฉนวนทั่วไป กล่าวคือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้จะสะสมมากขึ้นจนไม่สามารถทำให้กลับสู่สภาพเดิมได้ และส่งผลให้ความสามารถในการจับตัวกันของเรซิ่น(หรือ Epoxy หรือ Polyester) ลดลง การสูญเสีย ความสามารถในการจับตัวกันนี้ จะทำให้เกิดโพรงของอากาศขึ้นในชั้นของเทป ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ ฉนวนโพรงของอากาศเหล่านี้จะกระจายอยู่ทั่วฉนวน และอาจเกิดการดิสชาร์จขึ้นแบบไม่มีทิศทาง ซึ่งผล ของมันจะทำให้โพรงของอากาศเหล่านี้ไม่แสดงขั้วของสัญญาณดิสชาร์จบางส่วนตามที่ควรจะเป็น และ ยังส่งผลให้เกิดสัญญาณดิสชาร์จบางส่วนขึ้นที่มุม 45° และมุม 225° นั่นคือ การเกิดดิสชาร์จทางขั้วบวก และขั้วลบเท่า ๆ กัน (ไม่ว่ามากหรือน้อย) ที่ค่ามุมปกติ จะเป็นการแสดงถึงการเกิด Thermal Deterioration หรือเป็นการแสดงอายุของฉนวนนั่นเอง

ตารางที่ 2.9 ปัญหาจากการเสื่อมสภาพด้วยความร้อน (Thermal Deterioration) [16]

สาเหตุ	Polarity	ผลจากโหลด	ผลจากอุณหภูมิ	มุมที่เกิด PD
การเสื่อมสภาพ	ค่าด้านบวกจะ	ค่อนข้างน้อย	แปรผกผันกับ	45° และ 225°
จากความร้อน	ใกล้เคียงกับ		อุณหภูมิ	
	ค่าด้านลบ			
		L YTYYYYYYYYYYY	S	

2.5.9 ปัญหาจากการปรับเปลี่ยนโหลด (Load Cycling)

การปรับเปลี่ยนโหลด (Load Cycling) จะเป็นรูปแบบเฉพาะของ Thermal Deterioration ซึ่งแสดงถึงความเสื่อมสภาพที่เกิดขึ้นจากการจับตัวกันระหว่างฉนวนของ Ground wall กับฉนวนของ Turn (ในระบบ Multi-Turn Coil) หรือระหว่างฉนวนของ Groundwall กับฉนวนของ Strand (ใน ระบบ Roebel Bars) โดยความเครียดจากการเปลี่ยนแปลงของโหลดอย่างรวดเร็ว ซึ่งเกิดขึ้นซ้ำกัน จะ ส่งผลให้จุดเชื่อมต่อระหว่าง Groundwall กับ Strand หรือกับฉนวนของ Turn เสื่อมสภาพลง และ เสียหายได้ ได้ และจะก่อให้เกิดโพรงของอากาศขึ้นในฉนวนทางด้านของแกนทองแดง

ตารางที่ 2.	<b>10</b> ຳ	ปัญหาจากการเ	່ຮັບເເ	ปลี่ยนโ	หลด (L	oad C	Cycling)	[16]
-------------	-------------	--------------	--------	---------	--------	-------	----------	------

1.0186610					
สาเหตุ	Polarity	ผลจากโหลด	ผลจากอุณหภูมิ	มุมที่เกิด PD	
การปรับเปลี่ยน	ค่าทางด้านลบจะ	ค่อนข้างน้อย	แปรผกผันกับ	45°	
Load	มากกว่าค่าทางด้าน		อุณหภูมิ		
	บวก (≈1.5 เท่า)				

สัญญาณดิสชาร์จบางส่วนที่เกิดขึ้นจากสาเหตุนี้ จะเกิดขึ้นทางด้านขั้วลบ เกิดขึ้นที่มุม 45° และมีลักษณะเช่นเดียวกับกรณีการเกิด Thermal Deterioration กล่าวคือ จะมีลักษณะของการ แปรผกผันกับอุณหภูมิ ทั้งนี้ ในกรณีที่โพรงของอากาศนั้นมีขนาดใหญ่มาก จะมีความเป็นไปได้ว่า สัญญาณดิสชาร์จบางส่วนทางด้านขั้วลบจะมีการเพิ่มขึ้นตามโหลด เนื่องจากผลของการสั่นสะเทือนของ ตัวนำที่เพิ่มมากขึ้นตามแรงทางกลที่เพิ่มสูงขึ้น

2.5.10 ปัญหาจากความสกปรก (Contamination)

เนื่องจากบริเวณช่วงปลายของขดลวดจะถูกออกแบบให้แยกห่างออกจาก Ground Planes ดังนั้น สัญญาณดิสชาร์จบางส่วนที่เกิดขึ้นเนื่องจากความสกปรกในช่วงปลายของขดลวดนี้ จะขึ้นอยู่กับ ค่าแรงดัน Phase-to-Phase Voltage โดยค่าของมุมจะเปลี่ยนไป 30° จากสัญญาณปกติ (ที่ 45° และ 225°) ซึ่งทิศทางของมุมที่เปลี่ยนไปนี้จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เกิดความสกปรก และค่าแรงดันของ ขดลวด นั้น ๆ ซึ่งไม่สามารถระบุได้อย่างแน่นอน การตรวจสอบหรือการกำหนดตำแหน่งอาจทำได้ลำบาก เนื่องจากระยะการมองเห็นที่ค่อนข้างจำกัด และถึงแม้ว่าสัญญาณดิสชาร์จบางส่วนที่เกิดขึ้นจะมี ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ หรือจากการเปลี่ยนแปลงของโหลด แต่ก็ไม่สามารถ คาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนเช่นกัน อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อม เช่น ความชื้น อาจมี ผลกระทบค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ความสกปรกเหล่านั้นจะมีความสามารถในการนำ ไฟฟ้าได้เมื่อมีความชื้นเกิดขึ้น

ตารางที่ 2.11 ปัญหาจากความสกปรก (Contamination) [16]

สาเหตุ	Polarity	ผลจากโหลด	ผลจากอุณหภูมิ	มุมที่เกิด PD
ความสกปรก	ค่าทางด้านบวก จะใกล้เคียงกับค่า	ไม่มี	ไม่แน่นอน	15° , 75° , 195° และ 225°
	ทางด้านลบ	ROF		

2.5.11 ปัญหาจากการสั่นสะเทือนบริเวณช่วงปลายของขดลวด (Endwinding Vibration) สัญญาณดิสชาร์จบางส่วนจะไม่ใช่อาการที่เกิดจากการสั่นสะเทือนบริเวณช่วงปลายของ ขดลวด (Endwinding Vibration) อย่างไรก็ตาม ผลอย่างหนึ่งที่เกิดจากการสั่นสะเทือนบริเวณนี้ ก็คือ การเกิดรอยร้าวในฉนวน (ขนาดหลายเซนติเมตร) จากด้านปลายของ Slot ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่ารอย ร้าวเหล่านี้จะถูกพัฒนาไปถึงขั้นที่สามารถตรวจสอบสัญญาณดิสชาร์จบางส่วนได้ (จัดเป็นผลข้างเคียง จากการสั่นสะเทือนบริเวณช่วงปลายของขดลวด)

## 2.6 ฐานข้อมูลของผลการวัดสัญญาณดิสชาร์จบางส่วนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า2015 [2]

ทางบริษัท IRIS ได้ทำการเก็บข้อมูล Data base ของผลการวัดดิสชาร์จบางส่วนจากเครื่อง กำเนิดไฟฟ้าข้อมูลล่าสุดของปี 2015 อยู่ที่ 550,000 ข้อมูลซึ่งผู้ใช้งานสามารถใช้ข้อมูลนี้มาเปรียบเทียบ ได้ว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้นมีระดับความรุนแรงของดิสชาร์จบางส่วนสูงหรือต่ำเพียงใด ซึ่งเครื่องกำเนิด ไฟฟ้ามีพิกัด 21 kV และใช้ไฮโดรเจนในการระบายความร้อนที่ 3bar.g เมื่อนำมาแปลงเป็น Psig จะมีค่า อยู่ที่ 43.51 Psig จึงเลือกใช้ค่าของตาราง H<sub>2</sub> อยู่ที่ 31 – 50 Psig

Rated (V)		>19 kV	
H <sub>2</sub> (Psig)	21 - 30	31 – 50	≥51
Negilible (ต่ำมาก)	43	22	10
Low (ต่ำ)	94	49	27
Typical (ปกติ)	172	90	60
Moderate (สูงปานกลาง)	217	154	398
High (สูงเกินมาตรฐาน)	246	224	987

ตารางที่ 2.12 ฐานข้อมูลความรุนแรงของการเกิด PD พิกัด 21 kV [16]

จากตารางถ้าค่าดิสชาร์จบางส่วนที่วัดได้มีค่า

 ค่าดิสซาร์จบางส่วนที่วัดต่ำกว่า 22 mV แสดงว่ามีค่าดิสซาร์จบางส่วนต่ำมาก (Negligible) หรือ Stator Insulation อยู่ในสภาพดีเลิศ

 ค่าดิสชาร์จบางส่วนที่วัดมีค่าอยู่ในช่วง 23-49 mV แสดงว่ามีค่าดิสชาร์จบางส่วนต่ำ (Low) หรือ Stator Insulation อยู่ในสภาพดีมาก

 ค่าดิสชาร์จบางส่วนที่วัดมีค่าอยู่ในช่วง 50-90 mV แสดงว่ามีค่าดิสชาร์จบางส่วนปกติ (Typical) หรือ Stator Insulation อยู่ในสภาพดี

4) ค่าดิสซาร์จบางส่วนที่วัดมีค่าอยู่ในช่วง 91-154 mV แสดงว่ามีค่าดิสซาร์จบางส่วนสูงปาน กลาง (Moderate) หรือ Stator Insulation อยู่ในสภาพปกติ

5) ค่าดิสซาร์จบางส่วนที่วัดมีค่าอยู่ในช่วง 155-224 mV แสดงว่ามีค่าดิสซาร์จบางส่วนสูง (High) หรือ สูงเกินมาตรฐานที่ควรจะเป็น

### 2.7 การวิเคราะห์สัญญาณดิสชาร์จบางส่วน [4]

การแปลงเวฟเล็ต (Wavelet transform) เป็นคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ลักษณะของสัญญาณซึ่งมีประโยชน์มากในงานทางด้านการประมวลผลสัญญาณ (Signal processing) ทฤษฎีเวฟเล็ตสามารถ นำมาประยุกต์เพื่ออธิบายลักษณะ ของสิ่งต่างๆหรือระบบใดได้เช่นอธิบายปัญหา สมการดิฟเฟอเรลเซียลที่จำลองระบบใดระบบหนึ่ง การลดขนาดข้อมูล (ภาพ สัญญาณ)

2.7.1 ทฤษฎีพื้นฐานของการแปลงเวฟเล็ต

เมื่อใช้การแปลงฟูเรียร์ในการวิเคราะห์สัญญาณเฉพาะบางช่วงเวลาและความถี่เท่านั้นจะ เสียเวลาในการคำนวณมากเพราะต้องคำนวณใหม่ตลอดย่านดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาการแปลงที่สามารถ วิเคราะห์สัญญาณได้เฉพาะช่วงเวลาและความถี่ที่สนใจเท่านั้น ทำให้สามารถพิจารณาผล กระทบของ การเปลี่ยนแปลงของสัญญาณเฉพาะช่วงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว การแปลงที่พัฒนาขึ้นนี้เรียกว่า "การแปลงเวฟเล็ต"

การแปลงเวฟเล็ตเป็นรูปแบบหนึ่งของกระบวนการประมวลผลสัญญาณที่ได้มีการพัฒนามา จากการแปลงสัญญาณพื้นฐานที่มีอยู่เดิม แต่ได้พิจารณารูปแบบให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานเฉพาะ ทางมากยิ่งขึ้น ในหัวข้อนี้เป็นการอธิบายความหมายและความแตกต่างของการแปลงเวฟเล็ตกับการ แปลงสัญญาณในแบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจและนำไปใช้งานต่อไป

2.7.1.1 การแปลงฟูเรียร์ (Fourier transform: FT) การแปลงฟูเรียร์เป็นคณิตศาสตร์พื้นฐานในการวิเคราะห์ สัญญาณในโดเมนความถี่ ในสาขา การประมวลผลสัญญาณจึงนิยมการแปลงฟูเรียร์มาใช้งานกันอย่างแพร่หลายทั้งนี้เพราะการแปลงฟูเรียร์ จะมีสัญญาณไซน์และโคไซน์เป็นองค์ประกอบซึ่งโดยทั่วไปแล้วสัญญาณทั้งสองจะมีความสำคัญมาก เพราะเป็นสัญญาณพื้นฐานสำหรับพิจารณาสัญญาณอื่น ๆ โดยจะทำการแปลงสัญญาณจากโดเมนเวลา (Time-domain) ไปเป็นโดเมนความถี่ (Frequency-domain) หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าเป็นการหา สเปกตรัม (Spectrum) ของสัญญาณนั่นเอง บางครั้งสามารถกล่าวได้ว่าเป็นการวิเคราะห์สัญญาณโดย อาศัยฟังก์ชั่นพื้นฐาน (basic function) ในรูปของฟังก์ชั่นเอกซ์โพเนนเซียล ผลการวิเคราะห์จะออกมา ในรูปของการแตกองค์ประกอบของสัญญาณใด ๆ ให้อยู่ในรูปของฟังก์ชั่นโคไซน์ที่มีขนาดและความถี่ที่ แตกต่างกันตลอดย่านความถี่ - ∞ ถึง ∞ ดังแสดงในสมการที่ 2.3

$$F(n) = \sum_{-\infty}^{\infty} f(k) e^{-\left\lfloor \frac{j2\pi kn}{N} \right\rfloor}$$
(2.3)




ซึ่งมีสมการในเทอมของการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสุ่ม (sampling data) ที่เรียกว่า ฟูเรียร์แบบ เร็ว (Fast Fouries Transform : FFT) ดังสมการที่ 2.4

$$F(n) = \sum_{k=0}^{N-1} f(k) \cdot e^{-\left\lfloor \frac{j2\pi kn}{N} \right\rfloor}$$
(2.4)

เมื่อ n= 1,2,...N

ผลการวิเคราะห์สัญญาณด้วยการแปลงฟูเรียร์ได้แสดงอยู่ในรูปที่ 2.14 ซึ่งการวิเคราะห์ด้วย การแปลงฟูเรียร์จะมีแม่นยำด้านความถี่ และเหมาะสมในการวิเคราะห์สัญญาณที่มีลักษณะเป็น คาบเวลาที่แน่นอน (Stationary signal) แต่ข้อจำกัดของการแปลงฟูเรียร์คือ ในกรณีที่สัญญาณมีการ เปลี่ยนแปลงไม่คงที่ (Non – stationary signal) เช่น สัญญาณทรานเซียนต์รูปแบบต่าง ๆ การ วิเคราะห์ด้วยการแปลงฟูเรียร์จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นรวมทั้งข้อมูลทางด้านเวลาที่ขาดหายไป ซึ่ง ข้อมูลทางด้านเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการวิเคราะห์สัญญาณในลักษณะทรานเซี้ยนต์

#### 2.7.1.2 การแปลงกาเบอร์ (Gabor Transform : GT)

เป็นการแปลงสัญญาณที่ได้พัฒนาขึ้นเป็นแบบแรกเพื่อแก้ปัญหาของการแปลงฟูเรียร์ โดยทำการเปลี่ยนแปลงฟูเรียร์เฉพาะช่วงเวลาและช่วงความถี่ที่กำหนดผ่านฟังก์ชั่นหน้าต่าง (Windows function) ซึ่งจะเป็นลักษณ์ของฟังก์ชั่นแบบเกาส์เซียน (Gaussian function) ซึ่งอยู่ในสมการที่ 2.5

$$g_{a}(t) = \frac{1}{2\sqrt{\pi a}} e^{\frac{-t^{2}}{4a}}$$
(2.5)

ซึ่งมีสมการการแปลงกาบอร์ดังนี้

$$\left(G_{b}^{a}f\right)\left(w\right) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-jwt} f\left(t\right)g_{a}\left(t-b\right)dt$$
(2.6)

จากสมการที่ 2.6 เป็นสมการของการเปลงกาบอร์จะเห็นได้ว่าการแปลงในรูปแบบนี้สามารถ เลือกตำแหน่งในวิเคราะห์ได้โดยการกำหนดพารามิเตอร์ b ซึ่งจะให้ผลของข้อมูลทางเวลา และเลือกช่วง ความถี่ด้วยพารามิเตอร์ a แต่เนื่องจากการแปลงกาบอร์ให้ฟังก์ชั่นหน้าต่างแบบเดียว จึงอาจไม่ เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้งานในการวิเคราะห์สัญญาณในทุกรูปแบบได้

2.7.1.3 การแปลงฟูเรียร์ช่วงเวลาสั้น (Shot-Time Fourier Transform : STFT) จากข้อจำกัดการแปลงฟูเรียร์และการแปลงกาบอร์ จึงมีการพัฒนารูปแบบการ วิเคราะห์สัญญาณมาสู่การแปลงฟูเรียร์ช่วงเวลาสั้น ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ที่ใช้ฟังก์ชั่นหน้าต่างเหมือนการ แปลงกาบอร์ แต่สามารถเลือกฟังก์ชั่นหน้าต่าง ที่ใช้ได้จึงทำให้มีความยืดหยุ่นในการวิเคราะห์สัญญาณ มากยิ่งขึ้น สมการการแปลงฟูเรียร์ช่วงเวลาสั้นสามารถแสดงได้ดังสมการที่ 2.7

$$STFT(f,\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) w(t-\tau) e^{-j2\pi ft} dt$$
(2.7)

เมื่อ  $w(t-\tau)$  = Window function ที่ใช้ในการวิเคราะห์

โดยที่ตำแหน่งเวลาในการวิเคราะห์ถูกกำหนดโดยค่า *t* และช่วงความถี่การวิเคราะห์ กำหนด ด้วยความถี่หรือความกว้างของฟังก์ชั่นหน้าต่างนั้น ๆ ผลการวิเคราะห์จะอยู่ในรูปของการแตก องค์ประกอบสัญญาณในลักษณะการแปลงฟูเรียร์ในช่วงเวลาที่ทำการวิเคราะห์ดังแสดงในรูปที่ 2.16





สังเกตได้ว่าทั้งการแปลงกาบอร์และการแปลงฟูเรียร์ช่วงเวลาสั้น มีลักษณะของช่วงเวลาการ วิเคราะห์ที่คงที่ (Fixed resolution transform) ดังนั้นการใช้ช่วงการวิเคราะห์สัญญาณที่คงที่ในการ วิเคราะห์สัญญาณทุก ๆ ช่วงความถี่จึงอาจไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติ เนื่องจากสัญญาณที่มีความถี่สูงจะ มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วกว่า จึงควรจะใช้ช่วงเวลาที่แคบในการวิเคราะห์ ในขณะที่มีความถี่ต่ำกว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ช้าจึงควรใช้ช่วงเวลาที่กว้างกว่าในการวิเคราะห์ จากเหตุผลนี้ จึงได้มีการพัฒนา รูปแบบการวิเคราะห์สัญญาณที่มีการปรับระดับความละเอียดในการวิเคราะห์ ซึ่งเรียกว่า "การแปลง เวฟเล็ต"

2.7.2 การแปลงเวฟเล็ต (Wavelet Transform: WT)

การแปลงเวฟเล็ตจะใช้อธิบายโครงสร้างของระบบสัญญาณที่ประกอบด้วยกลุ่มของสัญญาณ เฉพาะมารวมกันเป็นสัญญาณหรือระบบนั้น ๆ โดยสัญญาณเฉพาะนี้จะเป็นคลื่นเล็ก ๆ ที่เรียกว่า "เวฟ เล็ต" ลักษณะของเวฟเล็ตจะเป็นคลื่นที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง (Oscillatary) และ ขนาดของ คลื่นจะลดลงสู่ศูนย์อย่างรวดเร็วทั้งสองด้าน ดังรูปที่ 2.16 ซึ่งเป็นเวฟเล็ตชนิดหนึ่งที่เรียกกว่าเวฟเล็ต แบบ Daubechies 20



ร**ูปที่ 2.16** ลักษณะของเวฟเล็ตแม่ชนิด Daubechies 20 [4]

การนำเวฟเล็ตหลาย ๆ อันมารวมกันเป็นกลุ่มเพื่อใช้อธิบายโครงสร้างของสัญญาณใด ๆ โดย ที่คลื่นเวฟเล็ตแต่ละตัวจะมีโครงสร้างมาจากฟังก์ชั่นเดียวกันซึ่งฟังก์ชั่นนี้จะเป็นเวฟเล็ตต้นกำเนิดที่ เรียกว่า "เวฟเล็ตแม่" (Mother Wavelets) คลื่นเวฟเล็ตแต่ละอันจะอยู่ภายในเชตของเวฟเล็ตนี้โดยแต่ ละคลื่นจะเกิดจากการสเกล (Scaling : "a") และการเลื่อนตำแหน่ง (Translation : "b") ดังนั้นถ้าให้  $\Psi(t)$  เป็นฟังก์ชั่นเวฟเล็ตแม่ สามารถเขียนเป็นสมการทั่วไปของเวฟเล็ตที่ตำแหน่ง "a", "b" ใด ๆ ที่ สัมพันธ์ได้ดังนี้

$$\Psi_{b,a}(t) = \frac{1}{\sqrt{a}} \Psi \left\lfloor \frac{t-b}{a} \right\rfloor$$
(2.8)

 $\Psi(t)$  จะเป็นฟังก์ชั่นเวฟเล็ตแม่ที่ถูกเลื่อนตำแหน่งและถูกสเกลโดยพารามิเตอร์ "a" และ "b" ตามลำดับ โดยที่ช่วงเวลาและความถี่ในการแปลงจะสัมพันธ์กันและเพื่อให้เวฟเล็ตที่ถูกสเกลไป แล้วมีพลังงานเท่ากับเวฟเล็ตแม่จึงต้องทำการนอมอร์ไลซ์ด้วย 1/ $\sqrt{a}$  เสมอ



ร**ูปที่ 2.17** แสดงลักษณะของเวฟเล็ตแม่ที่ถูกสเกลและเลื่อนตำแหน่งไปที่ค่า a,b ต่าง ๆ กัน [4]



รูปที่ 2.18 ลักษณะของการแตกกระจายสัญญาณและการรวมกลับสัญญาณของเวฟเล็ต

ทฤษฎีเวฟเล็ตจะใช้อธิบายสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมือนการแตกสิ่งนั้นออกเป็นส่วนประกอบเล็ก ๆ ที่ สัมพันธ์กันโดยชิ้นส่วนเหล่านี้จะอยู่ในรูปของเวฟเล็ตที่ถูกสเกลและเลื่อนตำแหน่ง ดังนั้นจึง เปรียบเสมือนว่าสัญญาณใด ๆ สามารถสร้างขึ้นมาได้โดยมีฟังก์ชั่นพื้นฐาน (Basis function) การแตก กระจายเวฟเล็ต (Wavelet Decomposition) ก็คือการทำการแปลงเวฟเล็ต (Wavelet Transform: WT) นั้นเอง ในทำนองเดียวกันการรวมกลับเวฟเล็ต (Wavelet Reconstruction) จะเป็นการแปลง กลับเวฟเล็ต (Inverse Wavelet Transform: IWT) ซึ่งเป็นการนำส่วนประกอบย่อย ๆ เหล่านี้มา รวมกันเพื่อประกอบเป็นสัญญาณเดิม ดังในรูปที่ 2.18

2.7.3 การแปลงเวฟเล็ตแบบต่อเนื่อง (Continuous Wavelet Transform : CWT)

รูปแบบของการแปลงเวฟเล็ตแบบต่อเนื่องนั้นมีลักษณะการวิเคราะห์สัญญาณโดยอาศัยการ ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของเวฟเล็ตแม่ที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ช่วงเวลาในการวิเคราะห์ที่แคบในการ วิเคราะห์องค์ประกอบความถี่สูง และช่วงในการวิเคราะห์ที่กว้างในการวิเคราะห์องค์ประกอบความถี่ต่ำ ซึ่งก็เป็นการปรับระดับความละเอียดในการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง ให้เหมาะสมกับความถี่ที่ทำการ วิเคราะห์ซึ่งสามารถแสดงสมการสำหรับการวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้

$$CWT(a,b) = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \Psi\left[\frac{t-b}{a}\right] dt$$
(2.9)

เมื่อ f(t) =สัญญาณที่ทำการแปลง

 $\Psi(t)$  = เวฟเล็ตแม่

a = แฟคเตอร์สเกล (scale)

b = แฟคเตอร์การเลื่อนตำแหน่ง (shifting)

จากการสมการที่ 2.9 เมื่อพิจารณาเทอมของ Ψ(t) ซึ่งเป็นเทอมของเวฟเล็ตแม่ที่เทียบได้
 กับเทอมของฟังก์ชั่นหน้าต่างในการแปลงฟูเรียร์ช่วงเวลานั้นเอง แต่เมื่อพิจารณาเทอมของ Ψ(t) จะมี
 การเปลี่ยนคุณสมบัติไปตามพารามิเตอร์ a และ b ซึ่งสามารถแสดงลักษณะในการวิเคราะห์ได้ดังนี้
 1) นำเวฟเล็ตแม่มาเปรียบเทียบกับส่วนแรกซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสัญญาณในสเกลแรก
 2) คำนวณสัมประสิทธิ์ (C) ซึ่งผลวิเคราะห์จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวฟเล็ตแม่ในสเกล

แรกกับสัญญาณในส่วนแรก ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์นี้ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้รูปร่างของเวฟเล็ตแม่ด้วย



รูปที่ 2.19 แสดงขั้นตอนที่ 1 และ 2 ของการแปลงเวฟเล็ต [4]

 3) เลื่อนตำแหน่งการวิเคราะห์ไปทางขวาและทำซ้ำในขั้นตอนที่ 1 และ 2 จนกระทั่ง ครอบคลุมช่วงสัญญาณทั้งหมด ซึ่งจากขั้นตอนที่ 1 - 3 นี้เป็นการแปลงเวฟเล็ตตลอดช่วงสัญญาณใน สเกลแรก



รูปที่ 2.20 แสดงขั้นตอนที่ 3 ของการแปลงเวฟเล็ต [4]

4) เปลี่ยนสเกลในการวิเคราะห์โดยการขยายสเกลและทำตามขั้นตอบที่ 1 - 3 ใหม่



รูปที่ 2.21 แสดงขั้นตอนที่ 4 จนกระทั่งครบทุกสเกล [4]

5) ทำตามขั้นตอนที่ 1 - 4 จนกระทั่งครบทุกสเกลจากขั้นตอนทั้งหมดผลการวิเคราะห์จะ ออกมาในรูปสัมประสิทธิ์ที่ได้การวิเคราะห์ของแต่ละสเกลในแต่ละส่วนของสัญญาณ และเนื่องจากการ แปลงเป็นไปในลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงสเกลและการเลื่อนตำแหน่งในการวิเคราะห์อย่างต่อ เนื่อง เมื่อนำผลมาวิเคราะห์ทั้งหมดมาแสดงรูปแบบความสัมพันธ์ของเวลาและความถี่ (Time – Scale) ได้ดัง รูปที่ 2.22



ร**ูปที่ 2.22** การแสดงการแปลงเวฟเล็ตแบบต่อเนื่อง (CWT) [4]

จากรูปที่ 2.22 แสดงให้เห็นว่าผลการวิเคราะห์เมื่อนำมาเขียนเป็นกราฟจะออกมาในรูปของ พื้นผิวที่ต่อเนื่องกันซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนสเกลในการวิเคราะห์ที่ต่อเนื่อง ซึ่งจะให้ความแม่นยำทางด้าน เวลาและความถี่ที่ดีแต่จะมีข้อเสียคือ ในการนำไปใช้งานที่ต้องการความรวดเร็วในการวิเคราะห์การ แปลงเวฟเล็ตแบบต่อเนื่องอาจไม่เหมาะสมเนื่องจากต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์ที่ค่อนข้างมากและ บางครั้งให้ข้อมูลที่ซ้ำซ้อนมากเกินความจำเป็น

2.7.4 การแปลงเวฟเล็ตแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Wavelet Transform : DWT) จากข้อจำกัดของการแปลงเวฟเล็ตแบบต่อเนื่องจึงมีการพัฒนารูปแบบการแปลงเวฟเล็ตมาสู่ การแปลงเวฟเล็ตแบบไม่ต่อเนื่อง ที่มีลักษณะการวิเคราะห์โดยเปลี่ยนสเกลและการเลื่อนตำแหน่งใน ลักษณะเป็นช่วง ๆ ไม่ต่อเนื่องกัน และก่อนที่จะกล่าวถึงรายละเอียดของการแปลงเวฟเล็ตแบบไม่ต่อ เนื่องจำเป็นที่ต้องกล่าวถึงทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในการอธิบายก่อน

2.7.4.1 การวิเคราะห์สัญญาณแบบหลายระดับความละเอียด (Multiresolution Analysis : MRA) จะเป็นการวิเคราะห์สัญญาณที่สามารถเลือกระดับความละเอียด a ซึ่งมี b หลาย ๆ ตำแหน่งมารวมกันเกิดเป็นสัญญาณที่ระดับความละเอียดที่เลือกไว้และเมื่อนำสัญญาณที่ทุกระดับความ ละเอียดมารวมกันจะเกิดเป็นสัญญาณอินพุทจริง

ก่อนที่จะศึกษาถึงการวิเคราะห์สัญญาณแบบ MRA จะขออธิบายถึงทฤษฎีพื้นฐานของสเปซ เวกเตอร์ (Vector space) ก่อนเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แบบ MRA

สเปซของเวกเตอร์ในการวิเคราะห์สัญญาณคือ สเปซหรือปริภูมิของสัญญาณใด ๆ ที่เกิดจาก การรวมกันของสัญญาณพื้นฐานย่อย ๆ ที่เรียกว่า "ฟังก์ชั่นพื้นฐาน" Basis function (b.f) ถ้ากำหนดให้ a,b เป็นจำนวนจริงใด ๆ และ  $\hat{i}, \hat{j}$  เป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยในสเปซเวกเตอร์ V เสมอ ดังนั้นถ้าเวกเตอร์ ใดประกอบข้นจากหลายเวกเตอร์หนึ่งหน่วยจะได้เวกตอร์นั้นคงอยู่ในสเปซเวกเตอร์นี้ ดังนั้น  $\hat{a}\hat{i}+\hat{b}\hat{j}+c\hat{k}+... \in V$  โดยที่เวกเตอร์หนึ่งหน่วย  $\hat{i}, \hat{j}$  จะเป็นลักษณะเชิงตั้งฉาก (Orthogonal) ซึ่งกัน และกัน ถ้าพิจารณาในลักษณะของสัญญาณอาจมองได้ว่า  $\hat{i}, \hat{j}$  คือฟังก์ชั่นพื้นฐานที่เป็นสัญญาณเล็ก ๆ ที่นำมาประกอบกันเป็นสัญญาณใด ๆ

สมมุติให้ V<sup>j</sup> เป็นสเปซเวกเตอร์ที่มี *j* แสดงถึงระดับความละเอียดและจำนวนของฟังก์ชั่น พื้นฐานที่ประกอบขึ้นเป็นฟังก์ชั่นนั้น ถ้า *j* มีค่าสูงขึ้นก็แสดงว่าที่ระดับความละเอียดสูงขึ้นจะมีจำนวน ฟังก์ชั่นพื้นฐานมากขึ้นทำให้สัญญาณที่เกิดจากการประกอบกันจากฟังก์ชั่นพื้นฐานมีความละเอียดมาก ขึ้นด้วย ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า *j* เป็นค่าแสดงถึงระดับความละเอียดของสัญญาณนั่นเอง จากข้อกำหนด เหล่านี้สามารถสรุปเป็นลักษณะสมบัติของการวิเคราะห์สัญญาณที่ระดับความละเอียดต่าง ๆ ได้ดังนี้

1)  $V^{-\infty}... \subset V^{-1} \subset V^{-1}...V^{\infty}$ 2) Close  $_{L^2} \left[ \bigcup_{j \in ZZZ} V^j \right] = L^2(IR)$ ; IR = เซ็ตของจำนวนเต็ม 3)  $\left[ \bigcap_{j \in Z} V^j \right] = \{0\}$ 4)  $V^j + W^j = V^{j+1}$ ;  $j \in Z; Z :=$  เซ็ตของจำนวนเต็ม

5) 
$$f(x) \in \mathbf{V}^{\mathbf{j}} \Leftrightarrow f(2x) \in V^{\mathbf{j}+1}$$
;  $\mathbf{j} \in \mathbf{ZZ}$ 

จากการที่ฟังก์ชั่นพื้นฐานประกอบกันเป็นสัญญาณการประมาณที่ระดับความละเอียด j ภายใน V<sup>i</sup> จะเรียก ฟังก์ชั่นพื้นฐานเหล่านี้ว่า ฟังก์ชั่นสเกลลิ่ง (Scaling function: **ф**(t)) สัญญาณเหล่านี้ จะเกิดที่ตำแหน่งเวลาต่าง ๆ กันของสเปซและมีความถี่เท่ากันภายในสเปซเดียวกันฟังก์ชั่นสเกลลิ่งที่ ระดับสเปซสูง (ระดับความละเอียดสูง) จะมีความถี่สูงและที่ระดับต่ำกว่าจะมีความถี่ต่ำกว่า ดังนั้น ความสัมพันธ์กันระหวางฟังก์ชั่นสเกลลิ่งของแต่ละสเปซจะเป็นดังนี้

$$f(x) \in V^{j} \Leftrightarrow f(2x) \in V^{j+1}; j \in ZZ$$
 (2.10)

จากการสมการที่ 2.10 ทำให้สามารถเขียนเป็นความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชั่นสเกลลิ่งภายใน สเปซใด ๆ ได้ดังนี้

$$\phi_{j,k}(t) = 2^{j/2} \phi(2^{j}t - k); j, k \in ZZ$$
(2.11)

จากสมการที่ 2.11จะพบว่าระดับความละเอียดต่ำลงมาหนึ่งระดับ ฟังก์ชั่นพื้นฐานจะมีความถี่ ลดลงมาครั้งละสองเท่า อาศัยลักษณะคุณสมบัติ MRA จะทำให้สามารถทำการประมาณสัญญาณ f, (t) ∈ L² (IR) ไปอยู่ในสเปซที่ระดับความละเอียด j ใด ก็ได้ดังนี้

$$f_j(t) = \sum_k c_k^j \phi_{j,k}(t)$$
(2.12)

โดยที่  $\mathcal{C}^{j}_{k}$  เป็นสัมประสิทธิ์หรือน้ำหนักที่คูณกับฟังก์ชั่นสเกลลิ่งที่ตำแหน่ง k ใด ๆ แล้ว ประกอบขึ้นเป็น  $f\left(t
ight)$ ที่ระดับความละเอียด j นั้น ๆ

จากคุณสมบัติข้อ 4 ของ MRA การวิเคราะห์สัญญาณที่ระดับความละเอียดต่ำลงมาจะทำให้ พลังงานหรือสัญญาณบางส่วนหายไปอยู่ในสเปซอีกอันหนึ่งซึ่งจะเรียกว่า "สเปซของเวกเตอร์เวฟเล็ต" (Wavelet vector space: *W*<sup>j</sup>) จะประกอบด้วย ฟังก์ชั่นพื้นฐานเช่นเดียวกันจะเรียกว่า "ฟังก์ชั่นเวฟ เล็ต" (Wavelet function ψ(t) ดังนั้นสามารถเขียนสมการฟังก์ชั่นเวฟเล็ต ที่ระดับความละเอียด ใด ๆ ได้ดังนี้

$$\Psi_{j,k}(t) = 2^{j/2} \Psi(2^{j}t - k); j, k \in \mathbb{ZZ}$$
(2.13)

จากสมการที่ 2.13 ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญาณที่มีการเลื่อนตำแหน่งและเปลี่ยนความถื่อย่าง ต่อเนื่องจะเปลี่ยนเป็นฟังก์ชั่นเวฟเล็ต  $\Psi_{j,k}\left(t
ight) = 2^{j/2}\Psi\left(2^{j}t-k
ight)$  ที่มีการเลื่อนตำแหน่งและ เปลี่ยนความถี่แบบไม่ต่อเนื่องโดยที่  $a=2^{-j},b=2^{-j}k$  ถ้ากำหนดให้  $g_i(t)$  เป็นสัญญาณที่เกิดจากฟังก์ชั่นพื้นฐานและ  $\Psi_{_{j,k}}(t)$  ภายในสเปซ เดียวกันมารวมกันเป็นสัญญาณใด ๆ จะได้ว่า

$$g_i(t) = \sum_k d_k^j \Psi_{j,k}(t)$$
(2.14)

โดยที่  $d_k^{\,j}$  เป็นสัมประสิทธิ์หรือค่าน้ำหนักที่คูณกับฟังก์ชั่นเวฟเล็ตที่ตำแหน่งนั้น ๆ เพื่อเกิด เป็นสัญญาณ  $g_i(t)$  ดังนั้นความสัมพันธ์  $V^{\,j} + W^{\,j} = V^{\,j+1}$ และจากสมการที่ 2.12 และ2.14 จะได้

$$f_{j+1} = f_i + g_i$$
 (2.15)

สมมุติให้ f(t) ∈V<sup>j+1</sup> จะสามารถแตกกระจายให้ f(t) ให้มีความละเอียดน้อยลงได้จากที่ สมการ V<sup>j</sup> +W<sup>j</sup> =V<sup>j+1</sup> ซึ่งในขณะเดียวกัน V<sup>j</sup> สามารถแตกต่อไปได้เรื่อยจนกระทั่ง j = 0 ดังนั้นจะ ได้เป็นความสัมพันธ์ว่า

$$V^{j+1} = V^0 + W^0 + W^1 \dots + W^j$$
(2.16)

ในทำนองเดียวกัน  $f_{j+1}$ ก็สามารถแตกกระจายเป็น  $f_j$  และ  $g_j$  ซึ่งสามารถแสดงเป็นภาพ การแตกกระจายสเปซและสัญญาณได้ดังดังรูปที่ 2.23 และ 2.24 f และ g ที่ลดระดับความละเอียดลง มาจะมีความถี่ของฟังก์ชั่นพื้นฐานลดลงครั้งละสองเท่าเสมอและเราสามารถแจกแจงสัญญาณ f(t) อยู่ ในรูปแบบของฟังก์ชั่นสเกลลิงและฟังก์ชั่นเวฟเล็ตได้ดังนี้



ร**ูปที่ 2.23** ลักษณะการกระจาย (Decomposition) ของสเปซของเวกเตอร์



ร**ูปที่ 2.24** ลักษณะการกระจาย (Decomposition) สัญญาณไปยังระดับความละเอียดต่าง ๆ รูปแบบการแตกกระจายสัญญาณ f(t) ใด ๆ ในสเปซ  $V^0$  ไปจนถึงระดับความละเอียดที่ j ใน รูปของสัมประสิทธิ์  $C_j(m)$  และ  $d_j(m)$  นี้เรียกว่า "การแปลงเวฟเล็ตแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Wavelet Transform: DWT)" โดยมีสมการที่ใช้อธิบายดังต่อไปนี้

$$DWT(m,n) = \frac{1}{\sqrt{a_0^m}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \Psi\left[\frac{t - nb_0 a_0^m}{a_0^m}\right] dt \qquad (2.18)$$

โดยที่

 $a_0^m$ 

 $nb_0a_0^m$  คือ การเลื่อนตำแหน่ง

สเกล

*m,n* คือ เลขจำนวนเต็ม

คือ

และในทางปฏิบัติการนำมาใช้งานจริง สัญญาณที่เข้ามาจะอยู่ในรูปของการสุ่ม (sample) ดังนั้น สมการที่ (2.18) จึงพัฒนามาสู่สมการที่ (2.19)

$$DWT(m,n) = \frac{1}{\sqrt{a_0^m}} \sum_{k} f(k) \Psi\left[\frac{n - k b_0 a_0^m}{a_0^m}\right]$$
(2.19)

เมื่อ *m,n,k* เป็นเลขจำนวนเต็มโดยที่

*n* คือ จำนวนข้อมูล

*m* คือ เลขแสดงการเปลี่ยนแปลงของสเกล

*k* คือ เลขแสดงการเลื่อนตำแหน่ง

เมื่อพิจารณาในรูปแบบของการวิเคราะห์หลายระดับความละเอียดแล้วโดยมีการเปลี่ยนแปลง สเกลในการวิเคราะห์ให้ลดลงครั้งละ 2 เท่า ( $a_0 = 2; b_0 = 1$ ) แล้วจะได้รูปแบบการแปลงเวฟเล็ต แบบ ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งมีชื่อเรียกว่า dyadic wavelet transform ดังสมการต่อไปนี้

$$DWT(m,n) = \frac{1}{\sqrt{2^m}} \sum_{k} f(k) \Psi\left[\frac{n-k2^m}{2^m}\right]$$
(2.20)

ซึ่งสามารถอธิบายหลักการทำงานได้โดยอาศัยหลักการวิเคราะห์ของฟิลเตอร์แบงค์ดังนี้

2.7.4.2 การวิเคราะห์ด้วยตัวกรองสัญญาณ (Filter Bank Analysis)

ขบวนการแปลงเวฟเล็ตจะมีลักษณะคล้ายกับขบวนการออคเทฟฟิลเตอร์แบงค์ (Octave filter banks) เนื่องจากการพิจารณาสัญญาณผ่านฟังก์ชั่นหน้าต่าง (Window function) ที่ สามารถเปลี่ยนแปลงความถี่ในอัตราครั้งละสองเท่าซึ่งเปรียบเสมือนกับการนำสัญญาณอินพุทผ่านวงจร กรองความถี่ที่มีแบบวิธีที่มีอัตราการลดลงสองเท่าเหมือนกับแบนวิธของฟังก์ชั่นหน้าต่างในขณะนั้น นั่นเอง ดังนั้นจะสามารถนำเอาหลักการของฟิลเตอร์แบงค์มาใช้ในการสร้างการแปลงเวฟเล็ตในทาง ปฏิบัติได้ ก่อนที่จะอธิบายการสร้างการแปลงเวฟเล็ตในลักษณะฟิลเตอร์แบงค์จะขออธิบายหลักการ พื้นฐานของฟิลเตอร์แบงค์ก่อน



รูปที่ 2.25 แสดงการแปลงแยกสัญญาณด้วยฟิลเตอร์แบงค์แบบสองช่องสัญญาณ



รูปที่ 2.26 แสดงการแปลงกลับสัญญาณด้วยฟิลเตอร์แบงค์แบบสองช่องสัญญาณ

ฟิลเตอร์แบงค์แบบสองช่องสัญญาณ (two filter banks)เป็นการแยกสัญญาณอินพุท ออกเป็น สองส่วนโดยแบ่งเป็นส่วนของความถี่ต่ำและส่วนของความถี่สูง ดังนั้นฟิลเตอร์แบงค์แบบสอง ช่องสัญญาณจึงประกอบด้วยส่วนที่เป็น ตัวกรองความถี่ต่ำ (low pass filter:L) และตัวกรองความถี่สูง (high pass filter : H) ดังรูปที่2.25 ซึ่งเป็นลักษณะของการวิเคราะห์ ฟิลเตอร์แบงค์แบบสองช่อง สัญญาณ (two – channel analysis filter banks) และเป็นโครงสร้างที่กลับกันกับการสังเคราะห์การ สร้างกลับฟิลเตอร์แบบสองช่องสัญญาณ (reconstruction two – channel synthesiss filter banks) ดังรูป 2.26 โดยที่ตัวกรองการกระจาย (Decomposition) ความถี่ต่ำและความถี่สูง คือ L และ H กับ ตัวกรองการสร้างกลับ (Reconstruction) ความถี่ต่ำและความถี่สูงคือ L',H' มีความสัมพันธ์กันใน ลักษณะที่เรียกว่า "Quadrature mirror filters"

ลักษณะของการวิเคราะห์ออคเทฟฟิลเตอร์แบงค์ (Octave analysis filter banks) จะเป็น โครงสร้างแบบต้นไม้ (Tree Structure) ซึ่งเป็นการสร้างเอาฟิลเตอร์แบงค์แบบสองช่องสัญญาณมาต่อ เรียงกัน โดยใช้สัญญาณเอาต์พุทในส่วนที่เป็นความถี่ต่ำมาทำการแยกแบนต์ความถี่ออกอีกครั้งหนึ่ง ใน กรณีที่ทำการแปลงเวฟเล็ตซ้ำในแนวของส่วนความถี่ต่ำเป็นลักษณะของ Dyadic tree structure ดังรูป ที่ 2.27 ซึ่งโครงสร้างในรูปนี้จะเป็นการแปลงแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Wavelet Transform : DWT)



รูปที่ 2.27 ลักษณะการแปลงเวฟเล็ตโดยใช้หลักการวิเคราะห์แบบออคเทฟฟิลเตอร์แบงค์

จากรูปที่ 2.27 เป็นลักษณะซึ่งเป็นลักษณะของการแปลงเวฟเล็ตแบบไม่ต่อเนื่องในลักษณะ ของ dyadic tree structure โดยมีสัญญาณอินพุทซึ่งเป็นสัญญาณที่ถูกสุ่มด้วยความถี่การสุ่ม =  $f_s$ (sampling rate) จะถูกวิเคราะห์ด้วยฟิลเตอร์ 2 ช่องสัญญาณในสเกลที่ 1(2<sup>1</sup>) ซึ่งสัญญาณจะถูกแยก ออกเป็น 2 ช่วงความถี่ คือ ส่วนความถี่สูงหรือ detail 1 มีความถี่อยู่ในช่วง  $\frac{f_s}{2} - \frac{f_s}{4}H_z$  และความถี่ ต่ำ หรือ Approximation 1 มีความถี่ในช่วง  $\frac{f_s}{4} - 0H_z$  และในการวิเคราะห์ในสเกลที่ 2(2<sup>2</sup>) ก็ทำ ได้โดยการคู่กรองชุดเดิมมาวิเคราะห์ต่อจาก Approximation 1 ซึ่งผลการวิเคราะห์จะออกมาเป็นส่วน ความถี่สูงสเกลที่ 2 หรือ detail 2 ซึ่งมีความถี่ในช่วง  $\frac{f_s}{4} - \frac{f_s}{8}H_Z$  และส่วนความถี่ต่ำสเกลที่ 2 หรือ Approximation 2 มีความถี่อยู่ในช่วง  $\frac{f_s}{8} - 0H_Z$  ถ้าทำการวิเคราะห์ต่อในสเกลที่ 3 ก็สามารถทำซ้ำ ในลักษณะเดิม ในทางกลับกันก็สามารถที่จะรวมสัญญาณที่ทำการกระจายในหลาย ๆ ช่วงความถี่ให้ กลับมาเป็นสัญญาณเดิมได้ ซึ่งผลการแปลงเวฟเล็ตแบบไม่ต่อเนื่องได้แสดงอยู่ในรูป 2.28



**รูปที่ 2.28** แสดงการแปลงเวฟเล็ตแบบไม่ต่อเนื่อง (DWT) ในสเกลที่ 1-4 [4]

2.7.5 เวฟเล็ตแม่ (Mother wavelet)

ในการวิเคราะห์สัญญาณใด ๆ ก็ตามนอกจากการเลือกรูปแบบในการวิเคราะห์ที่เหมาะสม แล้วยังมีความจำเป็นที่ต้องเลือกลักษณะของตัวกรองนั้น ๆ ให้เหมาะสมด้วย สำหรับการแปลงเวฟเล็ต นั้นตัวกรองสัญญาณที่ใช้คือเวฟเล็ตแม่นั้นเอง ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบและแต่ละแบบยังมีชนิด ย่อย ๆ ลงไปอีกและเนื่องจากรูปแบบของเวฟเล็ตแม่ที่หลากหลายนี่เองจึงทำให้การแปลงเวฟเล็ตมีความ ยืดหยุ่นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งาน โดยเลือกเวฟเล็ตแม่ให้เหมาะสมกับสัญญาณที่ทำการ วิเคราะห์ ซึ่งจะแสดงเวฟเล็ตแม่ดังต่อไปนี้

2.7.5.1 Haar Wavelet

เวฟเล็ต Haar เป็นเวฟเล็ตเป็นเวฟเล็ตชนิดแรกที่เริ่มต้นใช้กันและง่ายที่สุด เวฟเล็ต ชนิดนี้เป็นชนิดที่ไม่ต่อเนื่องกันและมีลักษณะคล้ายกับฟังก์ชั่นขั้นบันได ดังแสดงในรูปที่ 2.29





2.7.5.2 Daubechies Wavelet

Ingrit Daubechies เป็นนักวิจัยทางด้านเวฟเล็ตหนึ่งคน คนสำคัญของโลกที่ได้ค้นพบ สิ่งที่เรียกว่า "ขอบเขตที่แน่นอนของเวฟเล็ตเชิงเส้นตั้งฉากปกติ" (compactly - supported orthonormal wavelet) เป็นการสร้างขึ้นเพื่อวิเคราะห์เวฟเล็ตที่ไม่ต่อเนื่องในทางปฏิบัติ โดยใช้ชื่อเวฟ เล็ตตระกูลนี้ว่า "Daubechies" ซึ่งเขียนในรูป dbN โดยที่ N คือ การแสดงถึงลำดับ (order) หรือค่า สัมประสิทธิ์ตัวกรองนั้นเอง ดังแสดงในรูปที่ 2.30



รูปที่ 2.30 แสดงลักษณะของ Daubechies Wavelet [4]

#### 2.7.5.3 Biorthogonal Wavelet

เวฟเล็ตตระกูลนี้แสดงคุณสมบัติของเฟสเชิงเส้น ซึ่งใช้ในการฟื้นฟูสัญญาณและภาพ โดยใช้เวฟเล็ต 2 ตัว ตัวหนึ่งสำหรับแยกตัวประกอบ และอีกตัวหนึ่งสำหรับการสร้างใหม่แทนที่อีกตัว หนึ่งที่เหมือนกัน ที่ได้รับความสนใจในคุณสมบัติ ดังแสดงในรูปที่ 2.31



รูปที่ 2.31 แสดงลักษณะของ Biorthogonal Wavelet [4]

2.7.5.4 Coiflets Wavelet

เวฟเล็ตชนิดนี้ถูกสร้างขึ้นโดย L Daubechies โดยความต้องการของ R.Coifman เวฟเล็ตชนิดนี้จะมีฟังก์ชั่นพื้นฐานในลักษณะเกือบไม่สมมาตร (Nearly Asymmetric) ดังแสดงในรูป ที่ 2.32





2.7.5.5 Symlets Wavelet

เวฟเล็ตชนิด Symlets จะมีสัดส่วนที่สมมาตรเกือบทั้งหมด ซึ่งเวฟเล็ต นี้ถูกนำเสนอ โดย L.Daubechies ได้ปรับปรุงมาจากเวฟเล็ตตระกูล db ซึ่งคุณสมบัติของเวฟเล็ตทั้งสองตระกูลนี้มี ความคล้ายคลึงกัน ดังแสดงในรูปที่ 2.33



ร**ูปที่ 2.33** แสดงลักษณะของ Symlets Wavelet [4]

2.7.5.6 Morlet Wavelet

เวฟเล็ตชนิดนี้จะไม่มีฟังก์ชั่นการสเกลลิ่ง (scaling function) แต่จะมีความแน่นอน ดังแสดงในรูปที่ 2.34





2.7.5.7 Mexican Hat Wavelet

เวฟเล็ตนี้ไม่มีฟังก์ชั่นการสเกลลิ่ง (scaling function) และมีที่มาจากฟังก์ชั่นอนุพันธ์ อันดับสองของฟังก์ชั่นความหนาแน่นของความน่าจะเป็น เกาส์เซียน (the second derivative function of the Gaussian probability density function) ดังแสดงในรูปที่ 2.35



ร**ูปที่ 2.36** แสดงลักษณะของ Meyer Wavelet [4]

### 2.8 สรุปทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ทำการศึกษารูปแบบและวิเคราะห์สัญญาน ดิสชาร์จบางส่วนที่เกิดขึ้นในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พิกัด 21 kV พบว่าสัญญาณดิสชาร์จบางส่วนมีรูปแบบ ของสัญญาณที่เป็นลักษณะเฉพาะ รูปร่างและขนาดของสัญญาณขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และเซ็นเซอร์ที่ใช้ใน การตรวจวัด การวิเคราะห์สัญญาณดิสชาร์จบางส่วนด้วยการแปลงเวฟเล็ต เป็นการวิเคราะห์สัญญาน ดิสชาร์จบางส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเลือกช่วงเวลาและความถี่ที่สนใจไปวิเคราะห์ได้ ทำให้ สามารถพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณเฉพาะช่วงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทำให้การวิเคราะห์มีความแม่นยำ ในการหาค่าตำแหน่งเวลา และความถี่ โดยในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้สร้าง อัลกอริทึม เพื่อใช้วิเคราะห์สัญญาณดิสชาร์จบางส่วน เลือกใช้เวฟเล็ตแบบไม่ต่อเนื่องเพื่อกรองสัญญาน รบกวนความถี่สูงและความถี่ต่ำและใช้เวฟเล็ตแบบต่อเนื่อง เพื่อระบุตำแหน่งเวลา-ความถี่ ที่เกิด สัญญาณดิสชาร์จบางส่วน โดยอัลกอริทึมที่ได้จะนำไปวิเคราะห์กับสัญญานที่วัดได้จริง เพื่อเปรียบเทียบ ผลที่ได้กับเครื่องมือวัดมาตรฐาน และนำผลที่ได้ไปใช้ในการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่อไป



## บทที่ 3 วิธีการดำเนินงานวิจัย

ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย โดยการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลการเกิดดิสชาร์จบางส่วนใน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ออกแบบสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดสัญญาณ นำผลและข้อมูลวิเคราะห์หา สาเหตุและตำแหน่งที่เกิดดิสชาร์จบางส่วน ในขั้นตอนการวิเคราะห์ ได้สร้างแบบจำลองสัญญาณ ดิสชาร์จบางส่วน 4 รูปแบบและอีก 1 สัญญาณจริงจากโรงไฟฟ้า เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ โดยใช้การ แปลงเวฟเล็ตแบบไม่ต่อเนื่อง แยกสัญญาณรบกวนความถี่สูง และความถี่ต่ำ ออกจากสัญญาณจำลอง นำผลที่ได้ของสัญญาณมาวิเคราะห์หาค่าความถี่-เวลาด้วยการแปลงเวฟเล็ตแบบต่อเนื่อง เพื่อระบุ ตำแหน่งการเกิดดิสชาร์จบางส่วนในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า นำอัลกอริทึมที่ได้ไปทดลองใช้กับสัญญาณจริงที่ วัดได้ เปรียบเทียบผลกับเครื่องมือวัดมาตราฐาน TGA-B ณ บริษัทราชบุรีเพาเวอร์ จำกัดซึ่งเป็น โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน มีขนาดกำลังผลิตรวมทั้งสิ้น 1,400 เมกะวัตต์

#### 3.1 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย

- 3.1.1 ศึกษารูปแบบดิสชาร์จบางส่วนที่เกิดในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- 3.1.2 จำลองสัญญาณดิสชาร์จบางส่วนด้วยสมการทางคณิตศาสตร์
  - 3.1.2.1 สัญญาณ DOP
  - 3.1.2.2 สัญญาณ DEP
- 3.1.3 วิเคราะห์สัญญาณดิสชาร์จบางส่วนด้วยการแปลงเวฟเล็ต
  - 3.1.3.1 ลดสัญญาณรบกวนด้วยการแปลงเวเล็ตแบบไม่ต่อเนื่อง DWT
  - 3.1.3.2 หาค่าความถี่-เวลา ด้วยการแปลงเวฟเล็ตแบบต่อเนื่อง CWT
- 3.1.4 สรุปผลการวิเคราะห์
- 3.1.5 นำอัลกอริทึมที่ได้ไปใช้กับข้อมูลจริงที่ได้จากโรงไฟฟ้า
- 3.1.6 เปรียบเทียบผลที่ได้กับเครื่องมือวัดมาตราฐาน TGA-B



#### 3.2 การจำลองสัญญาณดิสชาร์จบางส่วน [12]

ปัญหาหลักในการวิเคราะห์สัญญาณ ดิสซาร์จบางส่วน คือ การหาขนาดรูปร่างของสัญญาณ ดิสซาร์จบางส่วนในความถี่ที่มีสัญญาณรบกวนสูง สัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มีทั้ง สัญญาณรบกวนแบบภายใน และสัญญาณรบกวนแบบภายนอก ในการลดสัญญาณรบกวน วิธีการแปลง เวฟเล็ตเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการแยกสัญญาณดิสซาร์จบางส่วนออกจากสัญญาณรบกวน การประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการลดสัญญาณรบกวน ได้ทำการจำลองสัญญาณดิสซาร์จ บางส่วนที่เกิดขึ้น และหาผลทดสอบเทียบกับผลอ้างอิง และนำผลทดสอบไปใช้กับข้อมูลที่วัดได้จริง ใน งานวิจัยนี้ ทำการจำลองสัญญานดิสซาร์จบางส่วน 4 สัญญาณ และอีก 1 สัญญาณเป็นค่าที่วัดได้จริง จากโรงไฟฟ้าราชบุรี [16 ]

ในการตรวจวัดสัญญาณดิสซาร์จบางส่วน รูปร่างและขนาดของสัญญาณจะขึ้นอยู่กับ ชนิดของ เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจจับ วงจรการตรวจจับจะใช้วงจรอิมพีแดนซ์ของ RC หรือ RLC Circuit โดย พัลส์แรงดันขาออกในวงจรอิมพีแดนซ์ RC จะแสดงเป็นพัลส์เอ็กซ์โปเนนเซียนที่หดตัว damped exponential pulse (DEP) ดังสมการที่ 3.1 และพัลล์แรงดันขาออกในวงจรอิมพีแดนซ์ RLC จะแสดง เป็นพัลส์แอมพลิจูดที่มีการสั่นสะเทือน damped oscillatory pulse (DOP) ดังสมการที่ 3.2

$$DEP(t) = A\left(e^{-\frac{(t-t_0)}{t_1}} - e^{-\frac{(t-t_0)}{t_2}}\right)$$
(3.1)

$$DOP(t) = A\sin(2\pi f_c(t-t_0)) \left( e^{-\frac{(t-t_0)}{t_1}} - e^{-\frac{(t-t_0)}{t_2}} \right)$$
(3.2)

โดยกำหนดให้

A = ค่าสูงสุดของสัญญาณพัลส์

 $t_1, t_2 = ค่าสัมประสิทธิ Damping$ 

t<sub>o</sub> = เวลาที่เกิดขึ้น

f<sub>c</sub> = ความถี่ของการสั่นของสัญญาณ DOP

รูปแบบของสัญญาณ DEP แสดงดังรูปที่ 3.1 และสัญญาณ DOP แสดงดังรูปที่ 3.2 โดย การจำลองสัญญาณดิสชาร์จบางส่วนตามสมการที่ (3.1) และ (3.2) และค่าพารามิเตอร์ต่างๆตามตาราง ที่ 3.1 โดยกำหนดให้ A และ f<sub>c</sub> เป็นค่าคงที่ มีค่าเท่ากับ 5 mV. และ 500 kHz ตามลำดับ Sampling rate ที่ 1 MHz. ทำการจำลองสัญญาณดิสชาร์จบางส่วน ตามรูปแบบDEP และ DOP โดยมีสัญญาณ รบกวนแบบ white Gaussian noise (WGN) ที่อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน (SNR) -5dB. รูปร่าง ของสัญญาณแสดงดังรูปที่ 3.3 และ 3.4 จำลองสัญญาณ DEP และ DOP ที่มีการรบกวนระดับ WGN at -10 dB and discrete spectral interference (DSI). ดังสมการที่ 3.3

$$e(t) = \sum_{i=1}^{5} (c + m \times \sin(2\pi f_m t)) \times \sin(2\pi f_i t)$$
(3.3)

โดยกำหนดให้

c คือ Amplitude carrier wave

- m คือ ค่า amplitude modulating signal
- f<sub>m</sub> คือ ความถี่ modulating signal
- f<sub>i</sub> คือ ความถี่ carrier wave

โดยค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ มีค่า c = 1, m=0.4, f <sub>m</sub> =1 kHz, f <sub>i</sub> = 400 kHz,500 kHz,600 kHz,700 kHz และ 800 kHz, ตามลำดับ

ชนิดสัญญาณ	จำนวนพัลลํ	t <sub>0</sub> ( $oldsymbol{\mu}$ s)	t1( $\mu$ s)	t <sub>2</sub> ( $oldsymbol{\mu}$ s)
	1	100	2	0.3
DEP	2	300	1.5	0.5
	3	700	4	0.5
	4	900	2	0.5
	1 R	100	5	0.1
DOP	2	300	4	0.1
	3	700	3	0.2
2	4	900	5.5	1
3		573	12	

**ตารางที่ 3.1** พารามิเตอร์ที่ใช้การจำลองสัญญาณดิสชาร์จบางส่วน

ตารางที่ 3.2 คุณลักษณะสมบัติของ DSI ที่ใช้ในการจำลองสัญญาณ

F(kHz)	400	500	600	700	800			
INR(dB)	-1.78	4.24	-7.8	1.74	6.18			
(DEP)								
INR(dB)	7.29	8.58	0.91	-14.6	-2.6			
(DOP)								



รูปที่ 3.1 รูปแบบสัญญาณ Damped exponential pulse (DEP)



ร**ูปที่ 3.3** สัญญาณ DEP ร่วมกับ white Gaussian noise (WGN) at SNR -5 Db



ร**ูปที่ 3.4** สัญญาณ DOP ร่วมกับ white Gaussian noise (WGN) at SNR -5 dB)

จากสมการที่ 3.1 และ 3.2 สามารถจำลองสัญญาณ DEP และสัญญาณ DOP ได้ดังรูปที่ 3.1 และรูปที่ 3.2 และสัญาณ DEP และสัญญาณ DOP ร่วมกับ white Gaussian noise แสดงดังรูปที่ 3.4 และรูปที่ 3.5 สัญญาณทั้งสองดังกล่าวจะนำไปวิเคราะห์ด้วยการแปลงเวฟเล็ตในขั้นตอนต่อไป

### 3.3 การวิเคราะห์สัญญาณด้วยการแปลงเวฟเล็ต

3.3.1 ผลการแยกสัญญาณรบกวนด้วยการแปลงเวฟเล็ตแบบไม่ต่อเนื่อง

เลือก Daubechies4 เป็นเวฟเล็ตแม่ ใช้เพื่อลดสัญญาณ DEP และ สัญญาณ DOP [6] โดย ลดสัญญาณลงในระดับ 12 ผลลัพธ์การขจัดสัญญาณรบกวนตามเวฟเล็ตแม่ แสดงในรูปที่ 3.5-3.9





รูปที่ 3.5 DWT coefficients (d1-d12, a12) of DEP type signal decomposed up to level 12 using db4 mother wavelet

เลือก Daubechies 4 เป็นเวฟเล็ตแม่ ในระดับการแปลงเวฟเล็ตเท่ากับ 12 การแปลงเวฟ เล็ตแบบไม่ต่อเนื่อง ของสัญญาณ DEP แสดงดังรูปที่ 3.5



ร**ูปที่ 3.6** De-noised DEP type signal ระดับ 12

จากรูปที่ 3.6 ผลของการแปลงเวฟเล็ตแบบไม่ต่อเนื่องในระดับ 12 แสดงให้เห็นว่าสัญญาณ รบกวนในระดับ 12 ลดลงเป็นอย่างมากและยังคงรักษารูปร่าง ตำแหน่งของสัญญาณต้นแบบเดิมอยู่ อย่างครบถ้วน โดยสัญญาณที่ได้จะนำไปวิเคราะห์ระบุตำแหน่งค่าเวลา-ความถี่ ด้วยการแปลงเวฟเล็ต แบบต่อเนื่อง ต่อไป



รูปที่ 3.7 DWT coefficients (d1-d12, a12) of DOP type signal decomposed up to level 12 using db4 mother wavelet.

เลือก Daubechies 4 เป็นเวฟเล็ตแม่ ในระดับการแปลงเวฟเล็ตเท่ากับ 12 การแปลงเวฟ เล็ตแบบไม่ต่อเนื่อง ของสัญญาณ DOP แสดงดังรูปที่ 3.7



รูปที่ 3.8 De-noised DOP type signal ระดับ 12

รูปที่ 3.8 เป็นการแปลงเวฟเล็ตแบบไม่ต่อเนื่องของสัญญาณ DOP โดยแยกสัญญาณ รบกวนความถี่สูง และความถี่ต่ำ ในระดับ12 ผลของการแยกสัญญาณรบกวนในระดับ 12 ดังรูปที่ 3.8 แสดงให้เห็นว่า สัญญาณที่ได้มีสัญญาณรบกวนน้อยมาก และยังคงมีรูปร่างของสัญญาณต้นแบบเดิม DOP อยู่อย่างครบถ้วน โดยสัญญาณที่ได้จะนำไปวิเคราะห์หาค่าเวลา-ความถี่ ด้วยการแปลงเวฟเล็ต แบบต่อเนื่อง ต่อไป

3.3.2 หาค่าเวลา-ความถี่ (Time-Frequency Domain)ด้วยการแปลงเวฟเล็ตแบบต่อเนื่อง



ร**ูปที่ 3.9** หาค่า Time Frequency Domain ด้วยเวฟเล็ตแบบต่อเนื่อง CWT

จากรูปที่ 3.9 เป็นการระบุตำแหน่ง เวลา ที่เกิดความถี่ของสัญญาณ DEP ด้วยเวฟเล็ต แบบต่อเนื่อง ที่ตำแหน่งเวลา t = 100 , 300 , 700 และ 900 µs เมื่อเทียบกับสัญญาณจริงที่จำลอง ค่าความถี่ เท่ากับ 0.5 x10<sup>6</sup> Hz ซึ่งตรงกับช่วงเวลาและความถี่ที่ได้จำลองไว้



ร**ูปที่ 3.10** หาค่า Time Frequency Domain ด้วยเวฟเล็ตแบบต่อเนื่อง CWT

จากรูปที่ 3.10 เป็นการระบุตำแหน่ง เวลา ที่เกิดความถี่ของสัญญาณ DOP ด้วยเวฟเล็ต แบบต่อเนื่อง ที่ตำแหน่งเวลา t = 100 , 300 , 700 และ 900 µs เมื่อเทียบกับสัญญาณจริงที่จำลอง อ่านค่าความถี่ ได้เท่ากับ 0.5 x10<sup>6</sup> Hz ซึ่งตรงกับช่วงเวลาและความถี่ที่ได้จำลองไว้







#### 3.5 สรุปการดำเนินงานวิจัย

การวิเคราะห์สัญญาณดิสชาร์จบางส่วนด้วยวิธีการแปลงเวฟเล็ต เป็นเทคนิคการขจัด สัญญาณรบกวนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งยังสามารถบีบอัดสัญญาณ และ สามารถกำจัดสัญญาณรบกวนได้ โดยลดทอนคุณภาพของสัญญาณลงไปจากเดิมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในงานวิจัยนี้ได้สร้างอัลกอริทึม โดย การจำลองสัญญาณดิสชาร์จบางส่วนด้วยฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์ คือ สัญญาณ DEP และ DOP ร่วมกับ สัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้น white Gaussian noise (WGN) เลือกเวฟเล็ตแม่แบบ Daubechies 4 และ ใช้เทคนิคการแปลงเวฟเล็ตแบบไม่ต่อเนื่องลดสัญญาณรบกวน ในระดับ12 พบว่าการแปลงเวฟเล็ตแบบ ไม่ต่อเนื่อง สามารถลดสัญญาณรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังคงรักษารูปร่างของสัญญาณ ต้นแบบ DEP และ DOP ที่ได้จำลองไว้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสัญญาณที่ได้นำไประบุตำแหน่งความถี่-เวลาที่ เกิดดิสชาร์จบางส่วนด้วยการแปลงเวฟเล็ตแบบต่อเนื่อง เทียบกับความถี่สัญญาณไซน์ 50 Hz เพื่อ วิเคราะห์สัญญานดิสชาร์จบางส่วนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว มีความถี่ตามคุณลักษณะของดิสชาร์จ บางส่วนคือ ประมาณ 50 – 250 MHz [2] หรือไม่ ซึ่งผลการทดลองจะนำเสนอในบทต่อไป



# บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์

ผลการวิเคราะห์การเกิดสัญญาณดิสชาร์จบางส่วนที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยผลการ วิเคราะห์จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

- 1) ผลการวิเคราะห์ดิสชาร์จบางส่วนจากอัลกอริทึมที่ออกแบบไว้
- 2) ผลการวิเคราะห์จากเครื่องมือวัดมาตรฐาน TGA-B

## 4.1 ผลการวิเคราะห์ดิสชาร์จบางส่วนจากอัลกอริทึมที่ออกแบบไว้

จากอัลกอริทึมที่ได้ออกแบบ นำไปใช้กับสัญญาณการวัดจากออสซิลโลสโคปความเร็วสูง โดยตั้งค่าอัตราการเก็บตัวอย่างสัญญาณ (Sampling rate) ที่ 100 MS/s และตั้งการอ่านค่าตัวอย่าง สัญญาณ (Sample to read) ที่ 5M พบสัญญาณผิดปกติเกิดขึ้นที่มุม 0° ของเฟส A และเกิดขึ้นซ้ำกัน ทุก 1 ไซเคิล



ร**ูปที่ 4.1** สัญญาณผิดปกติเกิดขึ้นที่มุม 0° Sample rate 100 M/s และSample to read 5M [16]

จากรูปที่ 4.1 จะเห็นได้ว่าเกิดความผิดปกติที่มุม 0° ในทุก 1 cycle จึงทำการวิเคราะห์ค่าของ สัญญาณที่ตรวจจับได้ เทียบกับสัญญาณไซน์ความถี่ 50 Hz

จากสูตร 
$$f=rac{1}{T}$$

ที่ความถี่ 50 Hz ค่าเวลา 
$$T=rac{1}{50Hz}$$
 $T=20ms$ 

เพราะฉะนั้นใน 1 cycle จะมีช่วงค่าเวลาเท่ากับ 20 mS และเครื่องมือวัดมาตรฐานTGA-B อ่านค่า Sample rate 100 MS/s และ Sample to read 5M ได้

$$T = \frac{5M}{100M S/s}$$
$$T = 50ms$$

จากการคำนวณจะเห็นได้ว่าการตั้งค่าของเครื่องมือวัดมาตรฐาน TGA-B ช่วงของเวลา 50mS เมื่อเทียบกับค่าความถี่ที่ 50 Hz อ่านค่าได้  $2rac{1}{2}$  cycle ซึ่งจัดว่าเป็นสัญญาณที่อยู่ในช่วงของ ความถี่เดียวกัน ดังนั้นการวิเคราะห์สัญญาณดิสซาร์จบางส่วนที่มีค่าความถี่สูงจำเป็นจะต้องลด ค่า ความถี่ Sample freguency และ จำนวนของข้อมูลลง เพื่อให้มีผลในการวิเคราะห์ที่ถูกต้องแม่นยำ จากอัลกอริทึมที่ได้ออกแบบไว้ นำมาใช้กับสัญญาณที่วัดได้จริง โดยใช้การแปลงเวฟเล็ต แบบไม่ต่อเนื่อง ลดระดับของสัญญาณในระดับสเกล 6 เลือเวฟเล็ตแม่ Daubechies4 ดังรูปที่ 4.2

4.1.1 ลดสัญญาณรบกวนด้วยเวฟเล็ตแบบไม่ต่อเนื่อง



รูปที่ 4.2 decomposed up to level 6 using db4 mother wavelet

รูปที่ 4.2 เป็นการลดสัญญาณด้วยการแปลงเวฟเล็ตแบบไม่ต่อเนื่อง โดยใช้เวฟเล็ตแม่แบบ Daubechies 4 ลดระดับสัญญาณรบกวนลงในระดับ 6 ผลของการลดสัญญาณรบกวนลงในระดับ 6 แสดงในขั้นตอนต่อไป



รูปที่ 4.3 ผลของการลดสัญญาณด้วยเวฟเล็ตแบบไม่ต่อเนื่องระดับ 6

จากรูปที่ 4.3 เป็นผลของการลดสัญญาณด้วยเวฟเล็ตแบบไม่ต่อเนื่อง ในระดับ 6 ซึ่งจำนวน ของข้อมูลจาก 5,208,334 ข้อมูล ลดลงเหลือ 81,314 ข้อมูล และความถี่ Sample freguency ลดลง ในระดับ 6 โดยที่รูปร่างของสัญญาณที่ได้ ยังคงรักษาตำแหน่ง เวลา ของสัญญาณเดิมอยู่ตลอดช่วง สัญญาณ ซึ่งค่าที่ได้นำไประบุค่าความถี่ - เวลา ด้วยการแปลงเวฟเล็ตแบบต่อเนื่องต่อไป



รูปที่ 4.4 Time - Frequency Domain signal

จากรูปที่ 4.4 เป็นการหาค่าเวลา–ความถี่ ที่เกิดดิสชาร์จบางส่วนด้วยการแปลงเวฟเล็ต แบบต่อเนื่องซึ่งจากกราฟแสดงให้เห็นว่า ความถี่ที่ต้องสงสัยที่ตำแหน่งเวลาแกน x =  $3.13 \times 10^{-4}$  s เมื่อ นำไปเปรียบเทียบกับสัญญาณที่เฟส A Sample rate 100 MS/s และ Sample to read 5M ซึ่งตรง กับช่วงเวลาแกน x =  $2.015 \times 10^{6}$  แสดงดังรูปที่ 4.5 และนำสัญญาณช่วงเวลาดังกล่าวที่ได้ ไประบุ เวลา-ความถี่อีกครั้ง ด้วยการแปลงเวฟเล็ตแบบต่อเนื่อง ดังรูปที่ 4.6



**รูปที่ 4.5** รูปร่างของสัญญาณสัญญาณที่เฟส A Sample rate 100 MS/s และ Sample to read 5M ในช่วงเวลา  $x = 2.015 \times 10^6$ 

จากกราฟในรูปที่ 4.5 เป็นการนำตำแหน่งเวลาที่สงสัยว่าเกิดดิสชาร์จบางส่วน จากรูปที่ 4.4 ที่ ช่วงเวลา 3.13x10<sup>-4</sup> s มาเปรียบเทียบกับสัญญาณจริงที่เฟส A Sample rate 100 MS/s และ Sample to read 5M ซึ่งพบว่าตรงกับช่วงเวลา 2.015x10<sup>6</sup> ในสัญญาณที่เฟส A โดยจะนำสัญญาณที่ได้ ในช่วง เวลาดังกล่าวไประบุความถี่ ต่อไป



จากค่าที่อ่านได้ 6.233 MHz นำไปคำนวณหาค่าความถี่ของดิสชาร์จบางส่วน จากความถี่ ของสัญญาณดิสชาร์จบางส่วนจะอยู่ในช่วง 1/(4xRise Time)

$$f_{PD} = \frac{1}{T} = \frac{1}{(4 \times rise \ time)}$$

เพราะฉะนั้นจะได้ค่าสัญญาณความถี่ดิสชาร์จบางส่วนที่เกิดขึ้นคือ

$$f = \frac{1}{1/6.233 \times 10^6/4}$$
  
= 24.932 *MHz*

### 4.2 ผลการวิเคราะห์จากเครื่องมือวัดมาตรฐาน TGA-B

ผลการวิเคราะห์จากเครื่องมือวัดมาตรฐาน TGA-B ทางทีมผู้วิจัยได้ทำการทดสอบและเฝ้า ติดตามการเกิดดีสชาร์จบางส่วนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลังจากที่ได้ทำการติดตั้งคาปาซิเตอร์คัปเปอร์ ดังรูปที่ 4.7 สามารถตรวจจับสัญญาณดีสชาร์จบางส่วนได้ที่สตรีมเทอร์ไบน์ 10 เมื่อเทียบค่ากับตาราง ฐานข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่า มีค่าสูงผิดปกติที่เฟส A และเฟส B แต่ค่าที่ผิดปกติของเฟส B เกิดจากการ อินดิ้วของกระแสจากเฟส A ไปยังเฟส B จึงทำการวิเคราะห์เฉพาะเฟส A เท่านั้น



รูปที่ 4.7 จุดที่ทำการตรวจสอบหาสาเหตุของสัญญาณดิสชาร์จบางส่วน



ร**ูปที่ 4.8** สัญญาณดีสชาร์จบางส่วนที่สตรีมเทอร์ไบน์ 10 เฟส A มุม 90° และ 270° [16]

จากตารางฐานข้อมูลความผิดปกติรุนแรงของการเกิดดิสชาร์จบางส่วนปี 2016 พบว่าค่าที่วัด ได้มีค่าต่ำมากหรือ Stator Insulation อยู่ในสภาพดีเลิศ และทำการวัดเก็บข้อมูลอีกครั้งปี 2017 พบว่า ค่าที่วัดได้นั้นมีค่าสูงมาก เมื่อเทียบค่าจากตารางฐานข้อมูลจะเห็นได้ว่าค่าสูงสุดอยู่ที่ 224 ซึ่งเป็นค่าที่มี ความผิดปกติอย่างเห็นได้ชัด และยังพบว่ามุมเฟสของสัญญาณการเกิดดิสชาร์จนั้น เกิดขึ้นที่มุม 90° และ 270°ของเฟส A ดังแสดงในรูปที่ 4.8 ซึ่งมุมเฟสที่เกิดขึ้นนั้นไม่เป็นไปตามลักษณะเฉพาะของ รูปแบบการเกิดดิสชาร์จบางส่วนซึ่งทาง IRIS POWER ENGINEERING, INC.ได้สรุปข้อมูลดังกล่าวว่า เป็นมุมการเกิดที่แตกต่างจากรูปแบบปกติและได้ทำการวิเคราะห์ลักษณะการเกิดดิสชาร์จบางส่วน ดังกล่าวว่า เกิดจาก Open air arc หรือ Corona แล้วจะมีการตรวจสอบงานจริงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2017



ร**ูปที่ 4.9** จุดที่ทำการตรวจสอบหาสาเหตุที่สตรีมเทอร์ไบน์ 10 เฟส A [16]
จากรูปที่ 4.9 เป็นการตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดดิสชาร์จบางส่วนที่สตรีมเทอร์ไบน์ 10 เฟส A และ สามารถตรวจพบที่มาของสาเหตุของการเกิดสัญญาณดิสชาร์จบางส่วนสตรีมเทอร์ไบน์ 10 ดังแสดงในรูปที่ 4.10-4.11



รูปที่ 4.10 จุดที่พบสาเหตุของการเกิดสัญญาณผิดปกติที่สตรีมเทอร์ไบน์ 10 เฟส A [16]



ร**ูปที่ 4.11** จุดที่เกิดความเสียหายของรู Isolated Phase Bus ที่ทำการต้าปเกลียวไม่ดี [16]

จากรูปที่ 4.11 จะเห็นได้ว่าจากการตรวจสอบหาสาเหตุนั้น พบว่า สาเหตุที่มาของสัญญาณ ผิดปกตินั้น เกิดจากการเจาะรูแล้วทำการตำปเกลียวไม่ดี เนื่องจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในขณะทำงาน หรือใช้งานไปนานๆ จะมีทั้งความร้อนและ การสั่นสะเทือน(Vibration) ตลอดเวลา จึงทำให้เกิดความ เสียหายขึ้น หลังจากทำการตรวจสอบหาสาเหตุของสัญญาณผิดปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้ทำการแก้ไข โดยการเพิ่มขนาดของน็อตตัวผู้ให้ใหญ่ขึ้น พร้อมทั้งทำการขยายรู Isolated Phase Bus เพื่อทำ การต๊าปเกลียวใหม่จากนั้นก็ทำการติดตั้งใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมของการใช้งานของชุดตรวจวัด สัญญาณก่อน Start up เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ภายหลังจากการตรวจสอบหาสาเหตุและทำการแก้ไข สามารถสรุปได้ว่า สาเหตุดังกล่าวเกิดจากความผิดพลาดในการติดตั้ง และได้มีกำหนดการตรวจสอบใน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2017 ด้วยเครื่องมือวัดมาตรฐานอีกครั้ง



# Pulse Height and Pulse Phase Analysis ABC Combo for C1 only Asset Name: STG10

Folder: Ratchaburi Power\, Asset Class: Hydro Generator

Operating Load: N/A, Reactive Load: N/A, Operating Asset Temp: N/A, Operating Voltage: N/A Ambient Temp: 30 deg C, Ambient Humidity: 66.00 % Freq. (Test Duration): 50 Hz, (5 sec.)



Iris Power LP, 3110 American Dr., Mississauga, On, Canada L4V 1T2, Phone: +1 (905)-677-4824, Fax: +1 (905) 677-8498

รูปที่ 4.12 Data Report STG 10 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2017 [16]

หลังจากการแก้ไขแล้ว ได้มีการตรวจวัดเพื่อหาสัญญาณความผิดปกติอีกครั้ง จาก Data Report ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2017 บริษัท IRIS ดังรูปที่ 4.12 แสดงผลในรูปของ Phase Angle ไม่ พบสัญญาณความผิดปกติแต่อย่างใด

# 4.3 สรุปผลการวิเคราะห์

ผลการวิเคราะห์การเกิดดิสชาร์จบางส่วนด้วยอัลกอริทึมที่อออกแบบ พบสัญญาณผิดปกติ เกิดขึ้นที่มุม 0° ของเฟส A และเกิดขึ้นซ้ำกันทุก 1 ไซเคิล โดยได้นำสัญญาณจากเฟส A ดังกล่าว มา วิเคราะห์หาความความถี่-เวลา ที่สงสัยด้วยเทคนิคการแปลงเวฟเล็ต ด้วยการลดสัญญาณรบกวนด้วย เวฟเล็ตแบบไม่ต่อเนื่องในระดับ 6 และระบุเวลา ความถี่ด้วยเวฟเล็ต ด้วยการลดสัญญาณรบกวนด้วย เวฟเล็ตแบบไม่ต่อเนื่องในระดับ 6 และระบุเวลา ความถี่ด้วยเวฟเล็ตแบบต่อเนื่อง โดยนำสัญญาณที่ลด ระดับลงแล้ว ไปเทียบตำแหน่ง เวลากับสัญญาณที่เฟส A ผลการทดลอง สรุปได้ว่า สัญญาณช่วงเวลาที่ สงสัยว่าจะเกิดดิสชาร์จบางส่วนที่มุม 0° ของเฟส A มีค่าความถี่ 24.932 MHz ซึ่งความถี่ในช่วงเวลา ดังกล่าวนั้นเป็นความถี่ที่จัดอยู่ในช่วงของสัญญาณรบกวน และเมื่อนำผลของการวิเคราะห์ที่ได้ไป เปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลของทางบริษัท IRIS พบว่าทั้ง 2 วิธีนั้น มีผลที่ได้จากการวิเคราะห์ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และจากการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสตรีมเทอร์ไบน์ 10 นั้นก็เป็นไป ตามที่ทางบริษัท IRIS และทางทีมผู้วิจัยได้สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดสัญญาณดังกล่าว ซึ่งจะสรุป ผลการวิจัยและนำเสนอใน บทถัดไป



# บทที่ 5 ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

# 5.1 สรุปผลการวิจัย

สัญญาณจริงที่วัดได้จากโรงไฟฟ้า ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพิกัด 21 kV ด้วยวิธีการติดตั้งแบบ Directional 2 PD Sensor/Phase ที่แก๊สเทอร์ไบน์ และสตรีมเทอร์ไบน์ พบว่าผลการวัดสัญญาณ ดิสชาร์จบางส่วนที่สตรีมเทอร์ไบน์ 10 จากเครื่องมือวัดแบบมาตรฐานTGA-B นั้นตรวจพบสัญญาณ ดิสชาร์จบางส่วนที่มุม 90° และ 270° ซึ่งทาง IRIS POWER ENGINEERING, INC.ได้สรุปข้อมูลดังกล่าว ว่าเป็นมุมการเกิดที่แตกต่างจากรูปแบบปกติและได้ทำการวิเคราะห์ลักษณะการเกิดดิสชาร์จบางส่วน ดังกล่าวว่า เกิดจาก Open air arc หรือ Corona

จากอัลกอริทึมที่ได้ออกแบบและนำไปวิเคราะห์สัญญาณที่ได้จากเครื่องมือวัดออสซิลโลสโคป ความเร็วสูง เมื่อนำสัญญาณมาวิเคราะห์ด้วยการแปลงเวฟเล็ตหาค่าดิสชาร์จบางส่วน โดยกรอง สัญญาณรบกวนในระดับ 6 ด้วยเวฟเล็ตแบบไม่ต่อเนื่อง และนำสัญญาณที่กรองแล้วไประบุตำแหน่ง เวลา-ความถี่ ด้วยเวฟเล็ตแบบต่อเนื่อง พบว่าสัญญาณที่วัดได้เกิดขึ้นที่มุม 0° และเกิดขึ้นซ้ำกันทุก 1 ไซเคิล อันเป็นผลเนื่องมาจากคุณสมบัติของ Capacitor load กล่าวคือกระแสไฟฟ้าจะนำหน้าความ ต่างศักย์เป็นมุม 90° จาก EMC Reference ได้มีข้อแนะนำให้ทำการเลื่อนมุมเฟสไป 90° ตามทฤษฎี ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า มุมของการเกิดดิสชาร์จบางส่วนที่วิเคราะห์จากอัลกอริทึมที่ออกแบบด้วย การแปลงเวฟเล็ต เป็นมุมเดียวกันกับผลการวิเคราะห์จากเครื่องมือวัดมาตรฐาน คือมุม 90° และ 270° และสัญญาณที่เกิดขึ้นมีความถี่ 24.93 MHz ซึ่งเป็นความถี่ที่จัดอยู่ในช่วงของสัญญาณรบกวน และจาก การตรวจสอบหาสาเหตุของสัญญาณผิดปกติพบว่า สาเหตุดังกล่าวอยู่ในส่วนของด้าน System ที่เกิดขึ้น จากความผิดพลาดในการติดตั้ง

# 5.2 ข้อเสนอแนะ

จากผลการทำวิทยานิพนธ์เรื่อง การตรวจจับสัญญาณดิสซาร์จบางส่วนในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ด้วยการแปลงเวฟเล็ต ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้

5.2.1 การลดสัญญาณรบกวนด้วยเวฟเล็ตแบบไม่ต่อเนื่องในหลายระดับ อาจนำไปสู่การลด สัญญาณดิสชาร์จบางส่วนออกจากสัญญาณที่วิเคราะห์

5.2.2 ในการหาค่าเวลา-ความถี่ ด้วยการแปลงเวฟเล็ตแบบต่อเนื่องนั้น ควรนำสัญญาณที่ วิเคราะห์ได้ไปเทียบกับสัญญาณจริง ในการหาค่าเวลา-ความถี่ โดยเทียบตำแหน่งเวลาของข้อมูลจริงกับ

# สัญญาณที่วิเคราะห์

5.2.3 เพื่อความถูกต้องของอัลกอริทึมที่ออกแบบ ควรนำไปใช้กับสัญญาณดิสซาร์จบางส่วน ที่ตรวจพบรูปแบบต่าง ๆ กัน

5.2.4 อัลกอริทึมที่ออกแบบ สามารถลดจำนวนครั้งในการใช้เครื่องมือมาตรฐาน ลด ค่าใช้จ่าย และ ลดเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลได้

# 5.3 งานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต

จากงานวิจัยนี้ได้ออกแบบสร้างอัลกอริทึม เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์สัญญาณดิสซาร์จบางส่วนที่ เกิดขึ้นในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พิกัด 21 kV ด้วยการแปลงเวฟเล็ตนั้น โดยกระบวนการในการวิเคราะห์ มี ขั้นตอนที่ยุ่งยากและซับซ้อน ซึ่งผู้ใช้งานต้องป้อนจำนวนข้อมูล (Data) และจำนวนความถี่สัญญาณ (Sampling frequency) รวมทั้งในการลดสัญญาณลงเพื่อกรองสัญญาณรบกวนถ้าการลดระดับของ สัญญาณรบกวนมากไปอาจนำไปสู่การกรองสัญญาณดิสซาร์จบางส่วนออกจากสัญญาณจริงก็ได้ ซึ่งใน งานวิจัยต่อไป ควรที่จะนำผลของการวิเคราะห์ไปพัฒนา การตรวจจับสัญญาณดิสซาร์จบางส่วนด้วย ระบบ AI เพื่อให้ผลการวิเคราะห์มีความแม่นยำ ลดขั้นตอนที่ซับซ้อนลง และออกแบบสร้างเครื่องมือ ตรวจวัดที่มีราคาถูกกว่าเครื่องมือวัดมาตรฐาน และที่สำคัญที่สุดจะต้องสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ได้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในระบบเชิงป้องกันในอนาคต ต่อไป



### บรรณานุกรม

- [1] สำรวย สังข์สะอาด, วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง พิมพ์ครั้งที่ 3. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรม ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ 2549
- [2] V. Warren and H. Sedding, Qualitrol Iris Power, "Partail Discharge Testing : A Progress Report" IRMC 2017
- [3] IRIS POWER. PD Seminar Module 1: Basic PD Theory, Detection and characteristics, November 2017
- [4] รศ.ดร. มนัส สังวรศิลป์, วรรัตน์ ภัทรอมรกุล, "การแปลงเวฟเลต," ใน คู่มือการใช้งาน MATLAB ฉบับบสมบูรณ์. ธนธัช การพิมพ์. : สำนักพิมพ์ อินโฟเพรส, 2543, หน้า.307-331
- [5] Tae-Sik Kong, Hee-Dong Kim, Tae-Sung Park, Kyeong-Yeol Kim, Ho-Yol Kim "Analysis of Partial Discharge Patterns for Generator Stator Windings" American Journal of Electrical Power and Energy Systems, 2015, pp.17-22
- [6] Takahiro Joyo, Tatsuya Okuda, Naoya Kadota, Ryoji Miyatake, Shinichi Okada "Phase Resolved Partial Discharge Patterns for Various Damage of Winding Insulation Detected with Different Measuring Devices" Electrical Insulation Conference (EIC), Baltimore, MD, USA, June 2017, pp.344-347
- [7] Yuanlin Luo, ID , Zhaohui Li and Hong Wang "A Review of Online Partial Discharge Measurement of Large Generators" Energies 2017
- [8] Pemen, A. J. M. (2000). "Detection of partial discharges in stator windings of turbine generators", Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven DOI: 10.6100 / IR530786
- [9] S. Sriram, S. Nitin, K. M. M. Prabhu, and M. J. Bastiaans "Signal Denoising Techniques for Partial Discharge Measurements" IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical InsulationVol. 12, No. 6, December 2005, pp. 182-1191
- [10] B. Vigneshwaran , Dr. P.Subburaj "An Improved Threshold Estimation Technique for Partial Discharge Signal Denoising Using Wavelet Transform" International Conference on Circuits, Power and Computing Technologies [ICCPCT-2013], 2013, pp.300-305

# บรรณานุกรม(ต่อ)

- [11] Mohammad Amin Kashiha, Diman Zad Tootaghaj and Dolat Djamshidi "Partial Discharge Source Classification and Denoising in Rotating Machines Using Discrete Wavelet Transform and Directional Coupling Capacitors" IEEE T&D Asia 2009
- [12] ALOK KUMAR PRADHAN "Analysis of Partial Discharge Signals using Digital Signal Processing Techniques" Roll No. 210EE2107, May 2012
- [13] Partha Ray, Ashok Kumar Maitraand Arijit Basuray "Extract Partial Discharge Signal using Wavelet for On-line Measurement" International conference on Communication and Signal Processing, April 2013, pp.888-892
- [14] Umar Khayam, Tria Kasnalestari "System of Wavelet Transform on Partial Discharge Signal Denoising " International Conference of Industrial, Mechanical 2016
- [15] X. Ma, C. Zhou and I. J. Kemp, "Interpretation of wavelet analysis and its application in partial discharge detection," IEEE Trans. Dielectrics and Electrical Insulation, vol. 9, no. 3, June 2002, pp.446-457
- [16] วรัญญ บุญเพ็ญ "การตรวจจับสัญญาณดีสชาร์จบางส่วนในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพิกัด 21 kV : กรณีศึกษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ณ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ของบริษัทราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด " 2018







# การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 12 The 12<sup>th</sup> Conference of Electrical Engineering Network 2020

26 - 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมรอยัล ฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

# หนังสือรวมบทความวิจัย

ไฟฟ้ากำลัง (PW) อิเล็กทรอนิกส์ วงจรและสื่อสาร (EC) อิเล็กทรอนิกส์กำลัง (PE) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (CP) ระบบควบคุมและการวัด (CT) พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน (ES) นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (IN) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า (GN) หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า (SS)



AUTO DIDACTIC CO., LTD



The 12<sup>th</sup> Conference of Electrical Engineering Network 2020 (EENET 2020)

# สถาบันเครือข่ายของการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า



26-28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 รอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ทแอนด์ สปา จังหวัดนครนายก





# การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า

การประชุมเครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Network: EENET) เป็นการ ประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มี ความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติเป็นอย่างมาก การประชุมวิชาการนี้เป็นการประชุมที่ตอบสนองต่อ ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และความ คิดเห็นระหว่างนักวิชาการและนักวิจัย โดยในปัจจุบันมีสถาบันที่เป็นสมาชิกเครือข่ายจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลทั้ง 9 แห่ง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัด "การประชุมวิชาการเครือข่าย วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 12 ( The 12<sup>th</sup> Conference of Electrical Engineering Network 2020: EENET2020) "

ครั้งที่	สถาบันเจ้าภาพ	ปี พ.ศ <mark>. ที่จัดงาน</mark>
1	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	2551
2	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ำนนา	2553
3	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	2554
4	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	2555
5	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	2556
6	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงกลศรีวิชัย	2557
7	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	2558
8	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	2559
9	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	2560
10	สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	2561
11	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	2562
12	มหาวิทยาลัยศรีนกรินทรวิโรฒ	2563



The 12<sup>th</sup> Conference of Electrical Engineering Network 2020 (EENET 2020)

### รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

อาจารย์ คร.มงคล มีลุน อาจารย์ คร.อรรถ พยอมหอม ผ้ช่วยศาสตราจารย์ คร.วิทยากร อัศครวิเศษ อาจารย์ คร.ยุทธพงศ์ ทัพผดุง ผ้ช่วยศาสตราจารย์ คร.อมารินทร์ แสงพานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.นาตยา กล้ายเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชิต เจริญ รองศาสตราจารย์ คร.ศราวุธ ชัยมูล รองศาสตราจารย์สรชัย สงสกลชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.วีรพล จิรจริต อาจารย์ คร.คริษฐา แจ้งสามสี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.พิสิทธิ วิสุทธิเมธิกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.อภิบาล พฤกษานุบาล อาจารย์ คร.คนชา ประเสริฐสม รองศาสตราจารย์สัมพันธ์ พรหมพิชัย รองศาสตราจารย์ราช พันธ์ฉลาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.วุฒิพร เถิศวาสนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.วุฒิวัฒน์ คงรัตนประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด กองสุข รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองศาสตราจารย์ คร.บุญยัง ปลั่งกลาง รองศาสตราจารย์ คร.จิรวัฒน์ คชสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.ปกรณ์เกียรติ์ เศวตเมธิกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.ณฐภัทร พันธ์คง ผ้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย แคงเอม ผ้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ แสดใหม่ อาจารย์ คร.วิเชียร อูปแก้ว รองศาสตราจารย์ คร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองศาสตราจารย์ทง ลานธารทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.สาคร วุฒิพัฒนพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.พูนศรี วรรณการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.วรินทร์ สุคคนึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.มนัส บุญเทียรทอง

กรมสอบสอนคดีพิเศษ (DSI) การไฟฟ้านครหลวง จฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมาเัพฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทค โน โลยีราชมงคลกรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทค โน โลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทค โน โลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



The 12<sup>th</sup> Conference of Electrical Engineering Network 2020 (EENET 2020)

# รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (ต่อ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว รองศาสตราจารย์พิชิต กิตติสวรรณ์ ผ้ช่วยศาสตราจารย์ คร.กันต์พงษ์ ศรีสถิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร. ใกรถกษ์ เชยชื่น ผ้ช่วยศาสตราจารย์ คร.ประสพโชค โห้ทองกำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.เจษฎาพร สถานทรัพย์ ผ้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิ์ชัย บณปิยทัศน์ ผ้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ แข็งสาริกิจ อาจารย์ คร.เอกสิทธิ์ นุกูลเจริญลาภ อาจารย์ คร.ปรัชณา มงคลไวย์ อาจารย์ คร.นิติกรณ์ ศิบป์ศิริวานิชย์ อาจารย์ คร.คมกฤช บุญยิ่ง อาจารย์ คร.บัญชา เหลือแคง อาจารย์ ดร.ทศพล ทิพย์โพธิ์ รองศาสตราจารย์ คร.พานิช อินต๊ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.วิโรจน์ ปงลังกา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.สิทธิบูรณ์ ศิริพรอักรชัย ผ้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์ สมไชยวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณพร ที่เก่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ พรมมี อาจารย์ ดร อนนท์ นำอิน อาจารย์ คร.พลกถษณ์ ทนคำ อาจารย์ คร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.ศุภกิต แก้วควงตา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.ชาญชัย เคชธรรมรงค์ อาจารย์ คร.นพคล มณีเฑียร ผ้ช่วยศาสตราจารย์ คร.ณรงค์ เมตไตรพันธ์ รองศาสตราจารย์ คร.วันไชย คำเสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.ชัยวัฒน์ สากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล รองศาสตราจารย์ คร.สมเกียรติ อุคมหรรษากูล รองศาสตราจารย์ปรีชา สาคะรังค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.คนุพล คำปัญญา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงกลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงกลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงกลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงกลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงกลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโบโลยีราชมงคลล้ำบบา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ำนนา ลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงกลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ



The 12<sup>th</sup> Conference of Electrical Engineering Network 2020 (EENET 2020)

### รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (ต่อ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.สรายุธ ทองกุลภัทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.ยุทธนา กันทะพะเยา ผ้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล เรื่องพัฒนาวิวัฒน์ อาจารย์ คร.พีรพล จันทร์หอม อาจารย์ คร.สมพร ศรีวัฒนพล อาจารย์ คร.มาถียา ตั้งจิตเจษฎา อาจารย์ คร.เฉลียว เกตุแก้ว ผ้ช่วยศาสตราจารย์ คร.ศิริวัฒน์ วสนธราเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.กฤติเคช บัวใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.สุริยา แก้วอาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย สง่างาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์เค่น คอกพิมาย ผ้ช่วยศาสตราจารย์อิสรีย์ วงศ์ศรีใส ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธินันท์ ต้นโพธิ์ อาจารย์ คร.มงคล ค่านบำรงตระกล อาจารย์ คร.ประจวบ อินระวงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.อรพิน ชาญนำสิน ผ้ช่วยศาสตราจารย์จรินทร์ศักดิ์ แซ่เตียว ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณะพงศ์ พันธ์ศรี ผ้ช่วยศาสตราจารย์จักรวัฒน์ บตรบณช อาจารย์ คร.ไพวรรณ เกิดตรวจ อาจารย์ คร.กัญจนา ชัยอมฤต ผู้ช่วยศาสตราจาร์ คร.วิชัย ครองกิจศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกวิทย์ หายักวงษ์ อาจารย์ คร.เสกสรร พลสวรรณ รองศาสตราจารย์ชาญชัย ทองโสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.อดิศักดิ์ ร่มพุฒตาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดา สมกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.บัณฑูร เวียงมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์ ผ้ช่วยศาสตราจารย์ คร.วัชระ วงค์ปัญโญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.ธนัสนี เพียรตระกูล รองศาสตราจารย์ คร.นัฐพร ไชยญาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวรรณภมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงกลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโบโลยีราชมงคลอีสาบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงกลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทกโนโลยีราชมงกลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทกโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

The 12<sup>th</sup> Conference of Electrical Engineering Network 2020 (EENET 2020)



# รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (ต่อ)

อาจารย์ คร.สุลักษณา มงคล รองศาสตราจารย์ คร.ศุภัฒน์ ถาวัณย์วิสุทธิ์ ผ้ช่วยศาสตราจารย์ คร.ณัฐที ถึงสบ รองศาสตราจารย์ คร.ปียะ โควินท์ทวีวัฒน์ ผ้ช่วยศาสตราจารย์ คร.พงษ์เทพ รักผกาวงศ์ อาจารย์ คร.สุธาสินี คุปตะบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.ระวี พรหมหลวงศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.ยอค สุขะมงคล รองศาสตราจารย์ คร.เวกิน ปียรัตน์ ผ้ช่วยศาสตราจารย์ คร.ประมวล ชรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.คณิศร์ มาตรา ผ้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพงษ์ ฉายสินธ์ ผ้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์ คล้ายมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์ อาจารย์ คร.ศรีศภางก์ ทิ้วสวรรณ อาจารย์อาคม ม่วงเขาแคง อาจารย์ธานินทร์ ดวงจันทร์ อาจารย์สุทธิพันธ์ อักษรเนียม อาจารย์นาวี รุจดามพ์ อาจารย์ธิติพร ประมวน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.สำเริง ฮินท่าไม้ อาจารย์ คร.วฤทธิ์ วิชกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.ยงยุทธ นาราษฎร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พกิจ สุวัตลิ์ รองศาสตราจารย์ คร.บุญเลิศ สื่อเฉย รองศาสตราจารย์ คร.บุญเรื่อง วังศิลาบัตร รองศาสตราจารย์ คร.สันติ หวังนิพพานโต ผ้ช่วยศาสตราจารย์ คร.ประสิทธิ์ นางทิน ศาสตราจารย์ คร.วงพงศ์ ตั้งศรีรัตน์ ศาสตราจารย์ คร.วิจิตร กิณเรศ รองศาสตราจารย์ คร.วินัย ใจกล้า รองศาสตราจารย์ คร.วิทยา ทิพย์สวรรณพร รองศาสตราจารย์ คร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุครธานี มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สถาบันเทคโนโลยีปทมวัน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาคกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารถาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารถาดกระบัง



The 12<sup>th</sup> Conference of Electrical Engineering Network 2020 (EENET 2020)

# สารบัญ (ต่อ)

ไฟฟ้ากำลัง (PW)		หน้า
PW-15	การตรวจจับสัญญาณดิสชาร์จบางส่วนในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยการแปลงเวฟเล็ต	57
	เริงฤทธิ์ กิจไพบูลทวี และฉัตรชัย ศุภพิทักษ์สกุล	
PW-16	การศึกษาอิทธิพลของน้ำที่ถูกกระตุ้นด้วยพลาสมา ณ สภาวะบรรยากาศ ต่อการเจริญเติบโตของเมล็ดพืช	61
	ยศธน ธนการัณย์ มงคล ลิ้มอาวัชนาการ ประที่ป บุญนอง พิชิตชัย สุวรรณเพชร และคณิศร์ มาตรา	
PW-17	การกำจัดเชื้อเอสเชอริเซียโคไล (อี โคไล) ด้วยดีสชาร์จแบบข้ามฉนวน	66
	ภานุวัฒน์ ทับอินทร์ ชิษณุพงศ์ ปฤกษา ศุภณัฐ นิ่มบัว ธีระวัฒน์ เต็มผลทรัพย์ ภัทธกร บุบผัน และคณิศร์	
	มาตรา	
PW-18	การวิเคราะห์สนามแม่เหล็กไฟฟ้าของสายไฟฟ้าได้ดิน 24 เควี ชนิดสาย XLPE ขนาด 400 ตร.มม.	70
	สมชาย ใกรปราบ ฤทธิชัย ราชแป้น ยุทธณา คงจีน ชานนท์ ชูพงษ์ และบุญยัง ปลังกลาง	
PW-19	การวิเคราะห์สนามแม่เหล็กของสายไฟฟ้าใต้ดินในท่ออีพ็อกซีเรซินเสริมใยแก้วที่จัดเรียงด้วยหวีเหล็ก	74
	และหวีฉนวน ภายในท่อใต้ดินแบบไปร์แจคกิง	
	ปรีชา มงคลสวัสดิ ฤทธิชัย ราชแป้น ยุทธณา คงจีน ณัชติพงศ์ อูทอง และบุญยัง ปลังกลาง	
PW-20	กระทบจากฤดูกาลที่มีต่อค่าความต้านทานการต่อลงดินในลักษณะเนื้อดินต่างกัน	78
	นฤเบศร์ เพื่อรศรี ชัยฎาพร จริงจิตร และชาญณรงค์ พงค์รักธรรม	
PW-21	Community Peer-to-Peer Energy Trading Analysis among Commercial Consumers in Korat	82
	Ashok Paudel Terapong Boonraksa and Boonruang Marungsri	
PW-22	การจำแนกสาเหตุความผิดพร่องในระบบจำหน่าย 33 kV ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ โดยใช้การ	86
	เรียนรู้ของเครื่อง	
	วิษณุ พรหมรัตน์ และวาทิต เบญจพลกุล	
PW-23	การพัฒนาอุปกรณ์ต่อร่วมมิเตอร์เอเอ็มอาร์เพื่อการเก็บข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์ฮาร์มอนิกของผู้ใช้ไฟฟ้าได้	91
	สาธิต เพื่องรอด และวาทิต เบญจพลกุล	
PW-24	การศึกษาการติดดังแหล่งจ่ายพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสานภายใต้การประจุโหลดยานยนต์ไฟฟ้า	95
	ปรเมษฐ์ นวมโคกสูง ยุทธณา คงจีน สุทธินันท์ ด้นโพธิ กฤติเคช บัวใหญ่ และกาณฑ์ เกิดชื่น	
อิเล็กทรอนิกส์ วงจ	รและสื่อสาร (EC)	
EC-01	การตรวจนับระดับแรงดันไฟฟ้าเกินของวงจรไฟตอนด้วยตัวเปรียบเทียบวินโดว์แบบอนุกรมในระบบอาณัติ	99
	สัญญาณรถไฟ	
	อุกฤษฎ์ กรกนก แสนศักดิ์ คีอ่อน ชีรพงศ์ อรชร และศักดิ์ทนงค์ วงศ์เจริญ	
EC-02	วงจรถูณค่าความจุไฟฟ้าเทียบกราวด์โดยใช้ไอซีเบอร์ LT1228 หนึ่งตัว	103
	นัชนัยน์ รุ่งเหมือนฟ้า เจษฎาพร สถานทรัพย์ และวรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์	
EC-03	วงจรเลียนแบบตัวเหนี่ยวนำแบบไม่มีการสูญเสียที่ปรับค่าได้โดยใช้ไอซีสำเร็จรูปเบอร์ LT1228	108
	พิชญานิน มูลเมือง ทัตยา ปุลคละนันทน์ และวรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์	
EC-04	วงจรกรองความถี่โหมดกระแสแบบสามอินพุตหนึ่งเอาต์พุตที่สามารถควบคุมได้ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์	112
	โดยใช้ VDTA หนึ่งตัว	
	อภิวัฒน์ ตันทอง กรันธ์ อังกูร ปวิช ช้อยขุนทค และภมร ศิลาพันธ์	
EC-05	การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบโอเอดีเอ็มร่วมกับเส้นใยแก้วเกรตติ้งชนิดแบร็ก	116
	ฎเบต แสงมะฮะหมัด วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร พุทธิพร เทียมสินสังวร และศุภเศรษฐ จันทร์อ่อน	



# การตรวจจับสัญญาณดิสชาร์จบางส่วนในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยการแปลงเวฟเล็ต

### Detection of partial discharge signal in generators using wavelet transforms

### เริงฤทธิ์ กิจไพบูลทวี<sup>เ</sup>และ ฉัตรชัย ศุภพิทักษ์สกุล<sup>2</sup>

<sup>1, 2</sup>ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี E-mail:roregrit\_k@mail.rmutt, chatchai.s@en.rmutt.ac.th

#### บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอวิธีการตรวจจับและระบตำแหน่งการเกิด ดิสชาร์จบางส่วน ในเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าพิกัด 21kV ด้วยเทคนิกการแปลง เวฟเล็ต สัญญาณจำลองดิสชาร์จบางส่วนในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่สร้าง ขึ้นจะถกนำมาลคสัญญาณรบกวน ค้วยเทคนิคการแปลงเวฟเล็ตแบบไม่ ต่อเนื่อง โดยการแยกส่วนประกอบของสัญญาณรบกวนความถี่สุงและ ความถี่ต่ำออกจากสัญญาณคิสชาร์จบางส่วนที่จำลอง สัญญาณที่กรอง แล้วนำมาผ่านกระบวนการระบุตำแหน่ง ด้วยการแปลงเวฟเล็ต แบบต่อเนื่องที่แสดงผลในโคเมนเวลา – ความถี่ โดยสัญญาณที่ตำแหน่ง ดังกล่าวจะถกนำไปวิเคราะห์หาค่าความถี่ และเปรียบเทียบตาม มาตรฐานคุณลักษณะสมบัติการเกิดดิสชาร์จบางส่วนในเครื่องกำเนิด ไฟฟ้า จากผลการทคลองกับสัญญาณดิสชาร์จบางส่วนที่จำลองขึ้น พบว่าอัลกอริทึมที่นำเสนอสามารถแยกสัญญาณรบกวนจากสัญญาณ ด้นแบบที่สร้างขึ้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เวฟเล็ตแม่ชนิด Daubechies 4 (Db4) และลดความละเอียดของสัญญาณตัวอย่างลง 12 ระดับ จากนั้นทำการระบุตำแหน่งและให้ค่าความถึ่ของสัญญาณ ดิสชาร์จบางส่วน ด้วยการแปลงเวฟเล็ตแบบต่อเนื่องได้อย่างถูกต้อง

<mark>คำสำคัญ :</mark> ดิสชาร์จบางส่วน, การแปลงเวฟเล็ตแบบไม่ต่อเนื่อง,การ แปลงเวฟเล็ตแบบต่อเนื่อง,โดเมนเวลา-ความถี่

#### Abstract

The purpose of this article was to present a method for detecting and locating partial discharges in generators 21 kV using wavelet transform technique. The signal from the sensor installed on the generator was used to decrease the noise with a discrete wavelet transform technique. This could be conducted by separating components of high and low frequency noise out of simulated partial discharge signals meanwhile filtered signals were taken through the locating process with continuous wavelet transform whose display was shown in the time-frequency domain. The signal obtained from that position would be analyzed for determining frequency in order to compare results according to the characteristics of partial discharges in generators. The experimental results indicated that the proposed algorithm could efficiently decrease noise with a condition of selected Daubechies 4 (Db4) as a mother wavelet and lowering the signal to level 12. The results showed that this condition could lead to accurate performance of locating the position and determining the frequency of partial discharge signal generated by continuous wavelet transform.

Keywords: Partial discharge, Wavelet transform, Discrete wavelet transform, Continuous wavelet transform, Time-frequency Domain

1. บทนำ

ในระบบการฉนวนไฟฟ้าแรงสูง ถ้าหากความเครียดสนาม ไฟฟ้าที่จดใดเกิดมีค่าสงกว่าก่ากวามเกรียดสนามไฟฟ้าวิกฤติ หรือก่า ความคงทนต่อแรงคันไฟฟ้า (Dielectric strength) ของฉนวนจะทำให้เกิด เบรกดาวน์โดยสมบูรณ์ หรือเบรกดาวน์เป็นเพียงบางส่วน หรือที่เรียกว่า "ดิสชาร์จบางส่วน" พัลส์ดีสชาร์จบางส่วนแต่ละครั้งจะมีพลังงาน ถ่ายเทให้กับพื้นผิวฉนวนในลักษณะชนกระแทกเป็นเหตุให้เกิดความร้อน เพิ่มขึ้นเฉพาะจด เป็นผลให้เกิดปฏิกิริยาทางเกมี ทำให้ฉนวนเสียเป็นจดๆ และเกิดผิดพร่องขยายตัวมากขึ้น และอาจนำไปส่ การเกิดเบรกดาวน์อย่าง ดิสชาร์จบางส่วนแบ่งออกเป็น 3 แบบคือ โคโรนา สมบรณ์ได้ ดิสชาร์จ ดิสชาร์จตามผิวและ ดิสชาร์จบางส่วนแบบภายในรอยต่อ การเกิดดิสษาร์จบางส่วนที่ฉนวนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จากข้อมูลที่มี การเก็บรวมรวมบันทึกไว้ทางสถิติ [1] พบว่ารูปแบบการเกิดดิสชาร์จ บางส่วนนั้น จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งของข้อบกพร่อง ในขดลวดสเตเตอร์และเทคนิคการตรวจวัด [2] ดังนั้นการวิเคราะห์ รปแบบการเกิคสัญญาณคิสชาร์จบางส่วนของเครื่องกำเนิคไฟฟ้าจะเป็น ประโยชน์อย่างมากในตรวจจับและการบำรุง รักษาตามประเภทของ ข้อบกพร่องในเครื่องกำเนิคไฟฟ้า การวิเคราะห์ สามารถแบ่งออกเป็น หลากหลายรูปแบบด้วยกัน เช่นการวิเคราะห์ดิสชาร์จบางส่วนใน รูปแบบ Phase Resolved Partial Discharge Pattern (PRPDP) ใน ฐปแบบสองและสามมิติ [3] การวิเคราะห์ด้วยโครงข่ายประสาทเทียม

### บทความวิจัย

### การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 12

The 12<sup>th</sup> Conference of Electrical Engineering Network 2020 (EENET 2020)

**PW-15** 

การวิเคราะห์รูปร่างดิสชาร์จบางส่วนและความหนาแน่นสเปกตรัม พลังงานดิสชาร์จบางส่วน เทคนิคการตรวจวัดดิสชาร์จบางส่วนใน โดเมนเวลา และแยกสัญญาณรบกวนด้วยการแปลงเวฟเล็ต การแยก สัญญาณดิสชาร์จบางส่วนออกจากสัญญาณรบกวน มีการประเมินวิธีลด สัญญาณรบกวนหลายวิธี โดยใช้ทั้งข้อมูลดิสชาร์จบางส่วนที่ได้จากการ จำลองทางคณิตศาสตร์ และข้อมูลที่วัดจริง พบว่าการแปลงเวฟเล็ตแบบ ไม่ต่อเนื่อง (Discrete wavelet transform ; DWT) สามารถแยกสัญญาณ รบกวน ได้ดีเมื่อเทียบกับ FFT และSTFT[4] นอกจากนี้การวิเคราะห์ สัญญาณดิสชาร์จบางส่วนในโดเมนเวลา - ความถี่สามารถทำได้โดยใช้ S – transform และการแปลงเวฟเล็ตแบบต่อเนื่อง (Continuous wavelet transform; CWT )[5]

### 2. ดิสชาร์จบางส่วนในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า [6]



**รูปที่ 1** วงจรสมมูลเมื่อมีโพรงอากาศในเนื้อฉนวน [6]

โดยปกติแล้วในฉนวนของขดลวดสเตเตอร์ จะมีโพรงของ อากาศปะปนอยู่ ถึงแม้ว่าเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องใหม่ก็ตามและถ้า โพรงอากาศนั้นมีขนาด 1 มิลลิเมตร แรงดันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตกคร่อม โพรงอากาศมีค่าสูงกว่า 3kV/mm (Vair/Dair)จะเกิดการเบรกดาวน์ 2 ครั้ง ภายในโพรงอากาศและในทุก 1 ไซเกิล จะเกิดการเบรกดาวน์ 2 ครั้ง ดังรูปที่ 1 เรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการเกิดสัญญาณดิส ชาร์จบางส่วน คือ การมีฉนวนบางส่วนเกิดสภาพการนำไฟฟ้าแต่ไม่ทำให้ ฉนวนโดยรวม ล้มเหลวในการเป็นฉนวน โดยขณะที่มีแรงดันตกกร่อมโพรงอากาศ เรียกว่า "ภาวะการชาร์จ" และขณะที่โพรงอากาศเกิดการเบรกดาวน์ เรียกว่า "ภาวะการดิสชาร์จ" ซึ่งจะเกิดทั้งลูกคลื่นบวก และลูกคลื่นลบ ของแรงดันรูปกลื่นไซน์ (Sine Wave) และจะเป็นเช่นนี้ไปตลอดจนกว่า จะได้รับการแก้ไข หรือจนกว่าฉนวนล้มเหลว

การเกิดดิสชาร์จบางส่วนเป็นสัญญาณที่มีความถี่สูงประมาณ 50-250 MHz และมีสัญญาณรบกวนในช่วงความถี่ 5 - 49 MHz ดังรูปที่ 2 มี Pulse Width แคบและมี RiseTime น้อยประมาณ 1-5 nS โดยความถี่ ของสัญญาณดิสชาร์จบางส่วนจะอยู่ในช่วง 1/(4xRise Time) รูปที่ 3



**รูปที่ 3** ลักษณะสัญญาณดิสชาร์จบางส่วน

# 3. การวิเคราะห์สัญญาณด้วยการแปลงเวฟเล็ต [4]

การ วิเคราะ ห์ด้วยการแปลงฟูริเยร์ (Fourier transform: FT) จะมีแม่นยำด้านความถี่ และเหมาะ สมในการวิเคราะ ห์สัญญาณที่มี ลักษณะเป็นคาบเวลาที่แน่นอน(Stationary signal) แต่ข้อจำกัดของการ แปลงฟูริเยร์ คือในกรณีที่สัญญาณมีการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ (Non stationary signal) การวิเคราะห์ด้วยการแปลงฟูริเยร์ จะมีความผิดพลาด เกิดขึ้นรวมทั้งข้อมูลทางด้านเวลาที่ขาดหายไป



รูปที่ 4 การแปลงฟูริเยร์ และการแปลงเวฟเล็ต

การใช้ช่วงการวิเคราะห์สัญญาณที่คงที่ ในการวิเคราะห์สัญญาณทุก ช่วงความถี่ จึงอาจไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติเนื่องจากสัญญาณดิสชาร์จ บางส่วนเป็นสัญญาณที่ มีความถี่สูงมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ดังนั้นจึงควรใช้ช่วงเวลาที่แคบในการวิเคราะห์ ในขณะที่ความถี่ต่ำจะมี การเปลี่ยนแปลงที่ช้า จึงควรใช้ช่วงเวลาที่กว้างกว่าในการวิเคราะห์ จากเหตุผลดังกล่าวนี้จึงได้มีการพัฒนา รูปแบบการวิเคราะห์สัญญาณที่ มีการปรับระดับความละเอียดในการวิเคราะห์ ซึ่งเรียกว่า "การแปลง เวฟเล็ต" (Wavelet Transform) ดังรูปที่ 4

### **PW-15**



การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 12 The 12<sup>th</sup> Conference of Electrical Engineering Network 2020 (EENET 2020)

4. ขั้นตอนการวิจัย

### 4.1 การจำลองสัญญาณดิสชาร์จบางส่วน [5]

ในการตร วจวัดสัญญาณดิสชาร์จบางส่ วน รูปร่างและ ขนาด ของสัญญาณจะขึ้นอยู่กับ ชนิดของเครื่องมือที่ใช้ในการตร วจจับ วงจร การสร้างสัญญาณตรวจจับจะใช้ วงจรอิมพีแดนซ์ vo RC หรือ RLC โดย พัลส์แรงดัน ขาออกใน วงจรอิมพีแดนซ์ RC จะแสดงเป็นพัลส์เอ็กซ์ โปเนนเชียนที่หดตัว damped exponential pulse (DEP) และพัลล์แรงดัน ขาออกใน วงจรอิมพีแดนซ์ RLC จะแสดงเป็น พัลส์แอมพลิจูดที่มีการ แกว่ง Damped oscillatory pulse (DOP) โดย ใช้ฟังก์ชั่นทางกณิตสาสตร์ สร้างสัญญาณ DEP และ DOP ตามสมการที่ 2 และ 3

$$DEP(t) = A\left(e^{-\frac{(t-t_0)}{t_1}} - e^{-\frac{(t-t_0)}{t_2}}\right)$$
(2)  
$$DOP(t) = A\sin\left(2\pi f_c\left(t-t_0\right)\right)\left(e^{-\frac{(t-t_0)}{t_1}} - e^{-\frac{(t-t_0)}{t_2}}\right)$$
(3)









โดยกำหนดให้ A คือก่าสูง สุดของ สัญญาณพัลส์ t<sub>1</sub> , t<sub>2</sub> คือ ก่าสัมประสิทธิ์ Damping , t<sub>0</sub> คือ เวลาที่เกิด , f ุคือ ความถึ่ของการสั่น สัญญาณ DOP, A และ f ู เป็นค่าคงที่มีค่าเท่ากับ 5 mV และ 500 kHz ตามลำดับ Sampling rate ที่ 10 MHz ทำการจำลองสัญญาณดิสชาร์จ บางส่วนตามรูปแบบ DEPและ DOP ตามสมการที่ 2 และ 3 ตามลำดับ สัญญาณทั้งสองแสดงดังรูปที่ 5 และ6

### 4.2 แยกสัญญาณรบกวนด้วยการแปลงเวฟเล็ตแบบไม่ต่อเนื่อง

จากการทดลอง สัญญาณ DEP จากรูปที่ 5 ข) และสัญญาณ DOP รูปที่ 6 ข) นำมาผ่านตัวกรองกวามถี่ด่ำและกวามถี่สูง เพื่อแยก องก์ประกอบสัญญาณ ออกเป็นส่วนที่มีความถี่ด่ำและส่วนที่มีความถี่สูง ในระดับ 12 โดยเลือก db4 เป็นเวฟเล็ตแม่ผลลัพธ์การลดสัญญาณตาม เวฟเล็ตแม่ ดังรูปที่ 7 และ 8 ซึ่งก่าที่ได้สัญญาณรบกวนลดลงเป็นอย่าง มาก และยังกงมีสัญญาณด้นแบบเดิม DEP และDOPอยู่ โดยผลลัพธ์ ที่ได้ จะนำไปวิเกราะห์หาก่าเวลา-กวามถี่ ในขั้นตอนต่อไป



# 4.3 หาค่า Time-Frequency Domain ด้วยการแปลงเวฟเล็ต แบบต่อเนื่อง

เมื่อลดสัญญาณรบกวนด้วยการแปลงเวฟเล็ตแบบไม่ ต่อเนื่องได้ในระดับที่ต้องการแล้ว ขั้นตอนต่อไปนำสัญญาณที่ได้มาระบุ ตำแหน่ง Time-Frequency Domain ด้วยการแปลงเวฟเล็ตแบบต่อเนื่อง เพื่อระบุ เวลา-ความถี่ ที่ด้องสงสัยในช่วงเวลาที่เกิดดิสชาร์จบางส่วน

รูป ที่ 9 แ ส ดงให้ เห็น ถึงผลที่ ได้ของการแปลงเวฟเล็ ต แบบต่อเนื่อง เพื่อหาค่าเวลา-ความถึ่ของสัญญาณ DEP จากกราฟจะเห็น ได้ว่าในช่วงเวลา 3.7 mS,8.7 mS 18.4 mS และช่วงเวลา 22 mS ตามลำดับ อ่าน ค่าความถี่ได้ โดยประมาณ 500 kHz ซึ่งทุกช่วงเวลาของสัญญาณ DEP ตรงกับสัญญาณดิสชาร์จบางส่วนต้นแบบที่ได้จำลองขึ้น

### บทความวิจัย

### การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 12

The 12<sup>th</sup> Conference of Electrical Engineering Network 2020 (EENET 2020)







จากรูปที่ 10 แสดงถึงการแปลงเวฟเล็ตแบบต่อเนื่อง ของ สัญญาณ DOP เพื่อหาค่าเวลา-ความถี่ จากกราฟจะเห็นได้ว่า ทุกช่วงเวลา ของสัญญาณ DOP ตรงกับสัญญาณดิสชาร์จบางส่วนของสัญญาณ ด้นแบบที่ได้จำลองขึ้น

#### 9. สรุปผลการทดลอง

ดิสชาร์จบางส่วนเป็นสัญญาณที่มีความถี่สูง มีการเปลี่ยน แปลงที่รวดเร็ว การวิเคราะห์สัญญาณด้วยการแปลงเวฟเล็ตให้ผลลัพธ์ใด้ เป็นอย่างดี โดยการแยกสัญญาณรบกวนความถี่สูงและความถี่ต่ำด้วยการ แปลงเวฟเล็ตแบบไม่ต่อเนื่องเลือก Db4 เป็นเวฟเล็ตแม่ เนื่องจากมี ความเหมาะสมในการวิเคราะห์สัญญาณลักษณะ ทรานเซียนต์เช่น ฟอลด์ และให้ความแม่นยำทางเวลาที่ดีโดยลดระดับสัญญาณในระดับ12 พบว่า สามารถกรองสัญญาณรบกวนลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังคงรักษา รูปร่างเวลาของสัญญาณด้นแบบเดิมที่ได้จำลองไว้คือ DEP และ DOP เมื่อนำสัญญาณที่ได้ไประบุตำแหน่งด้วยการแปลงเวฟเล็ตแบบต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์หาก่าเวลา-ความถี่ ที่เกิดดิสชาร์จบางส่วน พบว่าสามารถ ระบุก่าเวลา-กวามถี่ ได้ตรงตามสัญญาณที่ได้จำลองไว้ ซึ่งอัลกอริทึม ที่นำเสนอจะนำไปทดสอบตรวจวัดหาดิสชาร์จบางส่วนที่วัดจาก โรงไฟฟ้า เพื่อนำผลที่ได้ใช้ในการบำรุงรักษาระบบเชิงป้องกันต่อไป



### เอกสารอ้างอิง

- [1] V.Warren and H. Sedding, Qualitrol Iris Power, "Partail Discharge Testing : A Progress Report," Iris Rotating Machine Conference (IRMC), June 2017
- [2] C.V. Maughan, "Partial Discharge On-Line Testing of Turbine -Driven Generator Stator Windings", A Guide for the use of Partial Discharge in Assessing the Condition of Generator Stator
  - Windings, EPRI Interim Report, December 2000
- [3] Takahiro Joyo, Tatsuya Okuda, Ryoji Miyatake, Shinichi Okada,
  "Phase Resolved Partial Discharge Patterns for Various Damage of Winding Insulation Detected with Different Measuring Devices," Electrical Insulation Conference (EIC), June 2017, pp. 344-347
- [4] Mohammad Amin Kashiha, Dolat Djamshidi, "Partial Discharge Source Classification and Denoising In Rotating Machines Using Discrete Wavelet Transform and Directional Coupling Capacitors," IEEE T&D Asia, 2009
- [5] Gang Zhao, Dongxiang Jiang, "APPLICATION OF WAVELET TIME - FREQUENCY ANALYSIS ON FAULT DIAGNOSIS FOR STEAM TURBINE,"SURVEILLANCE 5 CETIM Senlis, october 2004 pp.11-13
- [6] IRIS POWER, "PD Seminar Module 1: Basic PD Theory, Detection and Characteristics,"



# ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล

**วัน เดือน ปี** 20 มีนาคม 2514

นายเริงฤทธิ์ กิจไพบูลทวี

ที่อยู่ปัจจุบัน การศึกษา 276 ม.8 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270 ปริญญาตรี ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

ตำแหน่งปัจจุบัน

ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ สังกัด คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สระบุรี

งานวิจัยที่สนใจ

Partial discharge detection in Power Generator , Signal analysis with wavelet transform

